

# 2.7 V~5.5 V 入力 2 A MOSFET 内蔵 1ch 同期整流 降圧 DC/DC コンバータ

## BD9A201FP4-LBZ

### 概要

本製品は産業機器市場へ向けた、長期の供給を保证するランクの製品です。これらのアプリケーションとして、ご使用される場合に最適な商品です。

BD9A201FP4-LBZ は低 ON 抵抗のパワー-MOSFET を内蔵した同期整流降圧 DC/DC コンバータです。カレントモード制御方式を採用しており、位相補償設定が容易であり、良好な負荷応答性能を実現します。パワーグッド機能を有しており、システムのシーケンス制御が可能です。

### 特長

- 産業機器に適した長期の供給保証
- 1ch 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
- 固定 PWM モード制御
- パワーグッド機能
- 過電圧保護機能 (OVP)
- 過電流保護機能 (OCP)
- 負荷短絡保護機能 (SCP)
- 温度保護機能 (TSD)
- 低入力電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- TSOT23-8L パッケージ

### 用途

- 産業機器
- NC 工作機械などの産業機器向け製品
- 2 次電源やアダプター向け機器
- 通信インフラ機器

### 重要特性

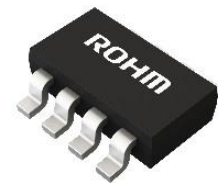
- 入力電圧範囲 : 2.7 V ~ 5.5 V
- 出力電圧範囲 :  $0.8 \text{ V} \sim V_{\text{IN}} \times 0.7 \text{ V}$
- 出力電流 : 2 A (Max)
- スイッチング周波数 : 1000 kHz (Typ)
- High-side FET ON 抵抗 : 50 mΩ (Typ)
- Low-side FET ON 抵抗 : 50 mΩ (Typ)
- シャットダウン時回路電流 : 0 μA (Typ)

### パッケージ

TSOT23-8L

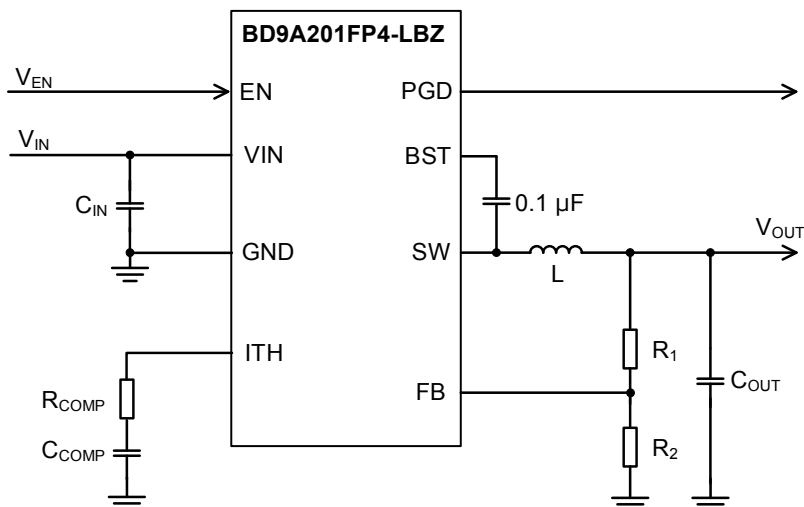
W (Typ) x D (Typ) x H (Max)

2.8 mm x 2.92 mm x 0.95 mm

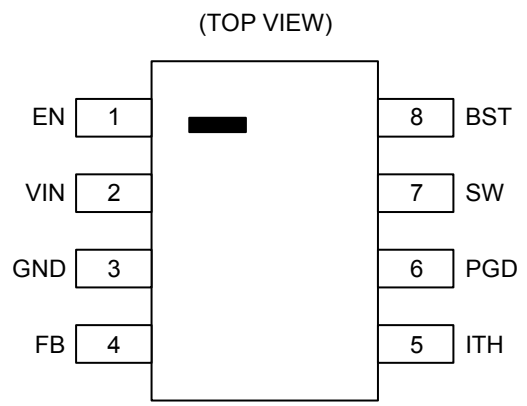


TSOT23-8L

### 基本アプリケーション回路



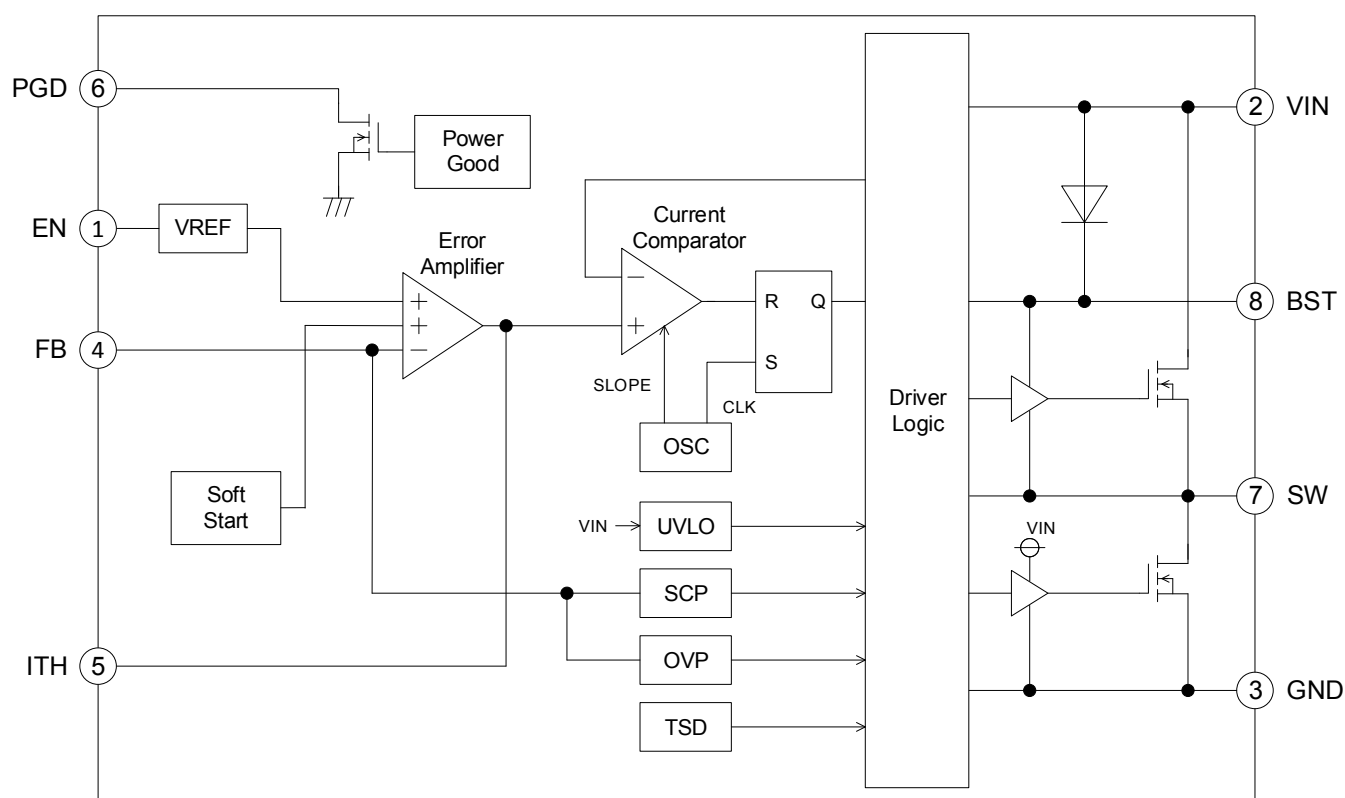
端子配置図



端子説明

端子番号	端子名	機 能
1	EN	イネーブル端子です。V <sub>EN</sub> を 2.0 V (Min) 以上にすると、デバイスが起動します。V <sub>EN</sub> を 0.8 V (Max) 以下にすると、デバイスがシャットダウンします。
2	VIN	電源入力端子です。推奨値として、0.1 μF (Typ) と 10 μF (Typ) のセラミック・コンデンサを接続してください。入力コンデンサ選定の詳細については、 <a href="#">アプリケーション部品選定方法 1. 入力コンデンサ</a> を参照してください。
3	GND	グラウンド端子です。
4	FB	出力電圧フィードバック端子です。出力電圧の設定方法は <a href="#">アプリケーション部品選定方法 3. 出力電圧設定</a> を参照してください。
5	ITH	Error Amplifier 出力端子、Current Comparator の入力端子となります。位相補償の設定方法に関しては <a href="#">アプリケーション部品選定方法 4. 位相補償部品</a> を参照ください。
6	PGD	パワーグッド端子です。オープンドレイン出力のため、プルアップ抵抗を必要とします。抵抗値の設定方法は、 <a href="#">機能説明 (3) パワーグッド</a> を参照してください。使用しない場合は、フローティング状態もしくはグラウンドに接続してください。
7	SW	スイッチング出力端子です。High-side FET のソース、Low-side FET のドレインに接続されています。この端子と BST 端子間にブートストラップコンデンサ 0.1 μF を接続します。また、インダクタを直流重畳特性に注意して接続してください。
8	BST	ブートストラップ用端子です。この端子と SW 端子の間にブートストラップコンデンサ 0.1 μF を接続します。この端子の電圧が High-side FET のゲート駆動電圧になります。

## ブロック図



## 各ブロック動作説明

1. VREF  
内部基準電圧を生成するブロックです。
2. UVLO (Under Voltage Lockout)  
低電圧誤動作防止ブロックです。入力電圧  $V_{IN}$  が 2.45 V (Typ) 以下になると、デバイスがシャットダウンします。スレッシュホールド電圧には 100 mV (Typ) のヒステリシスがあります。
3. SCP (Short Circuit Protection)  
負荷短絡保護回路です。ソフトスタート完了後、FB 端子電圧  $V_{FB}$  が 0.4 V (Typ) 以下の状態が 1 ms (Typ) 継続すると 16 ms (Typ) 間動作を停止し、その後に再起動します。
4. OVP (Over Voltage Protection)  
過電圧保護回路です。FB 端子電圧  $V_{FB}$  が FB 端子スレッシュホールド電圧  $V_{FBTH}$  の 110 % (Typ) 以上になると、出力段の MOSFET を OFF し、出力電圧の上昇を抑えます。 $V_{FB}$  が  $V_{FBTH}$  の 107 % (Typ) 以下になると、通常動作状態に戻ります。
5. TSD (Thermal Shut Down)  
温度保護回路です。温度保護回路は IC 接合部温度  $T_j$  が 175 °C (Typ) 以上になると、デバイスがシャットダウンします。 $T_j$  が低下すると、25 °C (Typ) のヒステリシスにて、デバイスが再起動します。
6. Soft Start  
ソフトスタート回路です。起動時、緩やかに出力電圧を立ち上げ、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を防ぎます。内蔵ソフトスタート機能により、1 ms (Typ) で立ち上がります。
7. Error Amplifier  
内部基準電圧と FB 端子電圧を入力とする誤差増幅器です。ITH 端子に抵抗とコンデンサを接続することで位相補償を設定できます。
8. Current Comparator  
Error Amplifier の出力電圧と、Slope 信号を比較するコンパレータです。出力スイッチングパルスのデューティを制御します。
9. Driver Logic  
スイッチング動作と保護機能動作を制御する回路です。
10. OSC (Oscillator)  
発振周波数を生成する回路です。
11. Power Good  
パワーグッド回路です。出力電圧が設定電圧の  $\pm 7$  % (Typ) 以内の電圧に達すると PGD 端子に内部接続されているオープンドレイン Nch MOSFET が OFF し、PGD 端子が Hi-Z (ハイインピーダンス) 状態になります。また、出力電圧が設定電圧の  $\pm 10$  % (Typ) の範囲を外れると、オープンドレイン Nch MOSFET が ON します。

## 絶対最大定格 (Ta = 25 °C)

項 目	記 号	定 格	単位
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ +7	V
SW 端子電圧	V <sub>SW</sub>	-0.3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3	V
SW 端子電圧 (10 ns パルス幅)	V <sub>SWAC</sub>	-3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3	V
BST – GND 間電圧	V <sub>BST</sub>	-0.3 ~ +14	V
BST – SW 間電圧	ΔV <sub>BST-SW</sub>	-0.3 ~ +7	V
FB 端子電圧	V <sub>FB</sub>	-0.3 ~ +7	V
ITH 端子電圧	V <sub>ITH</sub>	-0.3 ~ +7	V
EN 端子電圧	V <sub>EN</sub>	-0.3 ~ V <sub>IN</sub>	V
PGD 端子電圧	V <sub>PGD</sub>	-0.3 ~ +7	V
最高接合部温度	T <sub>jmax</sub>	150	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C

**注意 1:** 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただくようご検討をお願いします。

**注意 2:** 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

## 熱抵抗 (Note 1)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1 層基板 (Note 3)	4 層基板 (Note 4)	
TSOT23-8L				
ジャンクションー周囲温度間熱抵抗	$\theta_{JA}$	185.4	85.4	°C/W
ジャンクションーパッケージ上面中心間熱特性パラメータ (Note 2)	$\Psi_{JT}$	31.0	26.0	°C/W

(Note 1) JESD51-2 A (Still-Air) に準拠。

(Note 2) ジャンクションからパッケージ (モールド部分) 上面中心までの熱特性パラメータ。

(Note 3) JESD51-3 に準拠した基板を使用。

(Note 4) JESD51-5,7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1 層目 (表面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア (Note 5)	
			ピッチ	直径
4 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ0.30 mm

1 層目 (表面) 銅箔		2 層目、3 層目 (内層) 銅箔		4 層目 (裏面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm	74.2 mm□ (正方形)	35 μm	74.2 mm□ (正方形)	70 μm

(Note 5) 貫通ビア。全層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

## 推奨動作条件

項 目	記号	最小	標準	最大	単位
入力電圧	V <sub>IN</sub>	2.7	-	5.5	V
動作温度 <sup>(Note 1)</sup>	Topr	-40	-	+85	°C
出力電流 <sup>(Note 1)</sup>	I <sub>OUT</sub>	0	-	2	A
出力電圧設定 <sup>(Note 2)</sup>	V <sub>OUT</sub>	0.8	-	V <sub>IN</sub> x 0.7	V

(Note 1) 実動作環境下で T<sub>J</sub> は 125 °C 以下となるようご使用ください。ジャンクション温度が 125 °C を超えると動作寿命が低減する恐れがあります。

(Note 2) V<sub>OUT</sub> ≥ V<sub>IN</sub> × 0.1 [V] の範囲でご使用ください。

電気的特性 (特に指定のない限り Ta = 25 °C, V<sub>IN</sub> = 5 V, V<sub>EN</sub> = 5 V)

項 目	記号	最小	標準	最大	単位	条 件
<b>入力電圧</b>						
シャットダウン時回路電流	I <sub>STBY</sub>	-	0	10	μA	V <sub>EN</sub> = 0 V
動作回路電流	I <sub>OPR</sub>	-	350	500	μA	I <sub>OUT</sub> = 0 A スイッチング動作停止時
UVLO 検出スレッシュホールド電圧	V <sub>UVLO1</sub>	2.350	2.450	2.550	V	V <sub>IN</sub> falling
UVLO 解除スレッシュホールド電圧	V <sub>UVLO2</sub>	2.425	2.550	2.700	V	V <sub>IN</sub> rising
<b>イネーブル</b>						
EN スレッシュホールド電圧 High	V <sub>ENH</sub>	2.0	-	V <sub>IN</sub>	V	
EN スレッシュホールド電圧 Low	V <sub>ENL</sub>	GND	-	0.8	V	
EN 入力電流	I <sub>EN</sub>	-	5	10	μA	
<b>パワーグッド</b>						
Falling (Fault)電圧	V <sub>PGDFF</sub>	V <sub>FBTH</sub> x 0.87	V <sub>FBTH</sub> x 0.90	V <sub>FBTH</sub> x 0.93	V	V <sub>FB</sub> Falling
Rising (Good)電圧	V <sub>PGDRG</sub>	V <sub>FBTH</sub> x 0.90	V <sub>FBTH</sub> x 0.93	V <sub>FBTH</sub> x 0.96	V	V <sub>FB</sub> Rising
Rising (Fault)電圧	V <sub>PGDRF</sub>	V <sub>FBTH</sub> x 1.07	V <sub>FBTH</sub> x 1.10	V <sub>FBTH</sub> x 1.13	V	V <sub>FB</sub> Rising
Falling (Good)電圧	V <sub>PGDFG</sub>	V <sub>FBTH</sub> x 1.04	V <sub>FBTH</sub> x 1.07	V <sub>FBTH</sub> x 1.10	V	V <sub>FB</sub> Falling
PGD 出力リーク電流	I <sub>LKPGD</sub>	-	0	5	μA	V <sub>PGD</sub> = 5 V
PGD ON 抵抗	R <sub>PGD</sub>	-	100	200	Ω	
PGD Low Level 電圧	P <sub>GDVL</sub>	-	0.1	0.2	V	I <sub>PGD</sub> = 1 mA
<b>基準電圧、誤差増幅器、ソフトスタート</b>						
FB 端子スレッシュホールド電圧	V <sub>FBTH</sub>	0.792	0.800	0.808	V	
FB 入力電流	I <sub>FB</sub>	-	-	1	μA	V <sub>FB</sub> = 0.8 V
ITH 端子ソース電流	I <sub>ITHSO</sub>	10	20	40	μA	V <sub>FB</sub> = 0.7 V
ITH 端子シンク電流	I <sub>ITHSI</sub>	10	20	40	μA	V <sub>FB</sub> = 0.9 V
ソフトスタート時間	t <sub>SS</sub>	0.5	1.0	2.0	ms	
<b>SW (MOSFET)</b>						
スイッチング周波数	f <sub>OSC</sub>	800	1000	1200	kHz	
最大 Duty	D <sub>MAX</sub>	70	-	-	%	
High-side FET ON 抵抗	R <sub>ONH</sub>	-	50	100	mΩ	ΔV <sub>BST-SW</sub> = 5 V
Low-side FET ON 抵抗	R <sub>ONL</sub>	-	50	100	mΩ	
<b>保護</b>						
短絡保護検出	V <sub>SCP</sub>	0.28	0.40	0.52	V	

## 特性データ (参考データ)

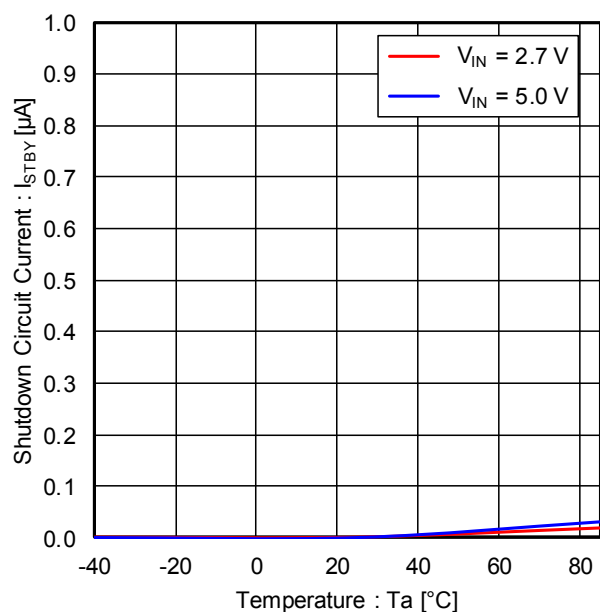


Figure 1. シャットダウン時回路電流 vs 温度

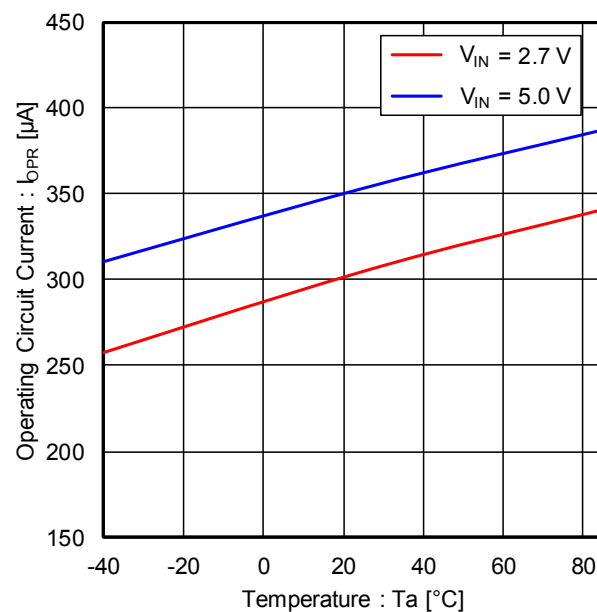


Figure 2. 動作回路電流 vs 温度

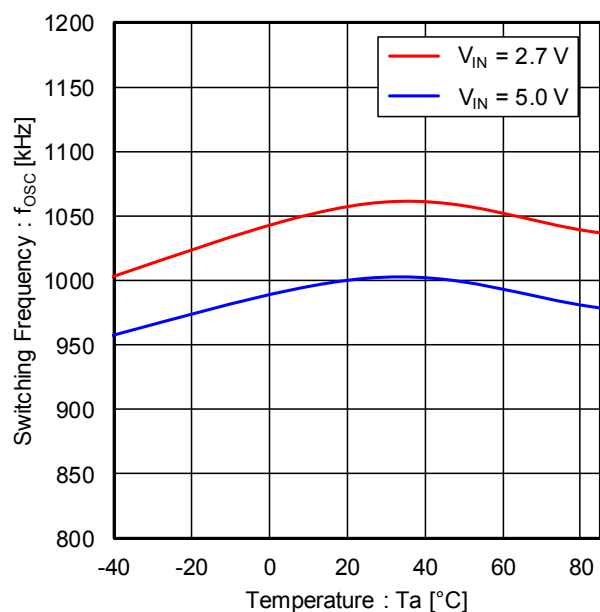


Figure 3. スイッチング周波数 vs 温度

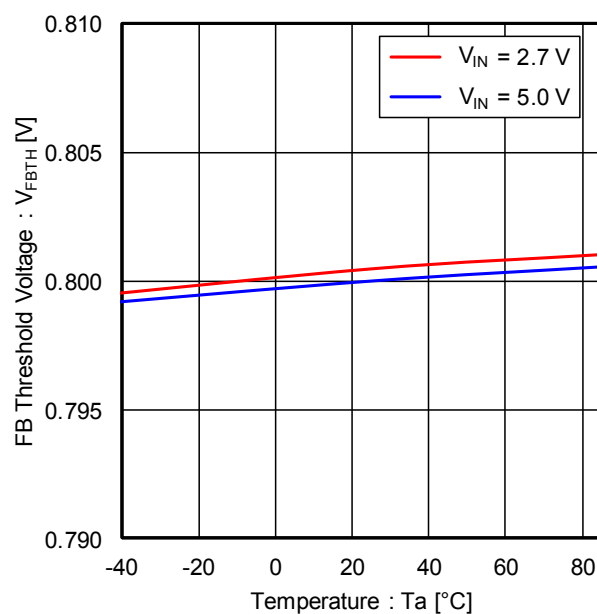


Figure 4. FB 端子スレッシュホールド電圧 vs 温度

特性データ (参考データ) — 続き

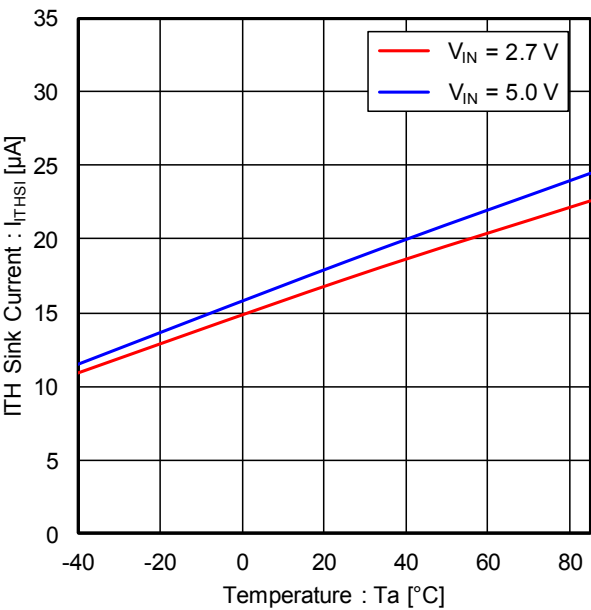


Figure 5. ITH シンク電流 vs 温度

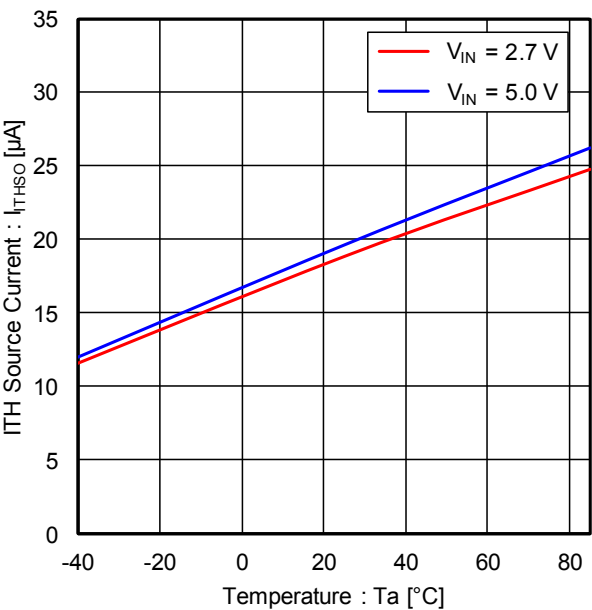


Figure 6. ITH ソース電流 vs 温度

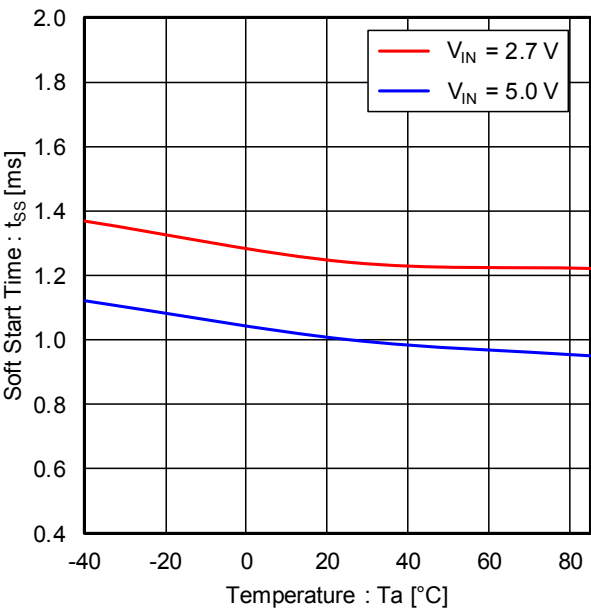


Figure 7. ソフトスタート時間 vs 温度

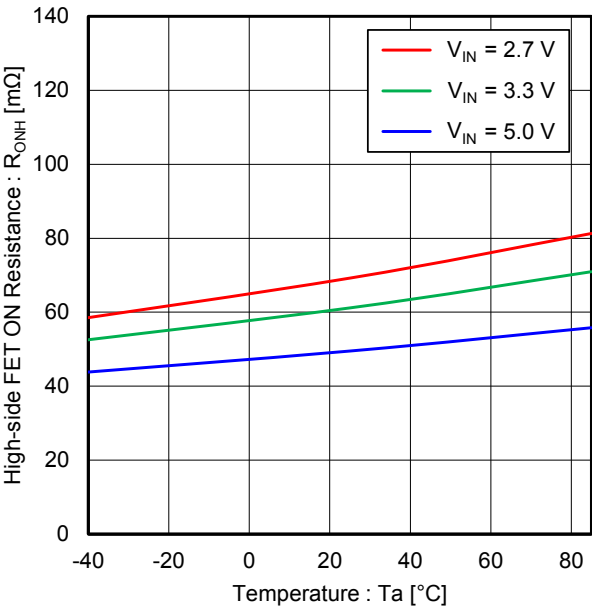


Figure 8. High-side FET ON 抵抗 vs 温度



特性データ (参考データ) — 続き

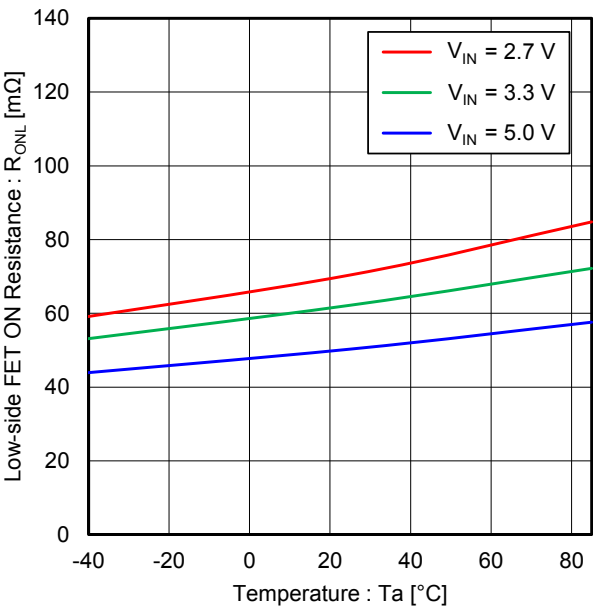


Figure 9. Low-side FET ON 抵抗 vs 温度

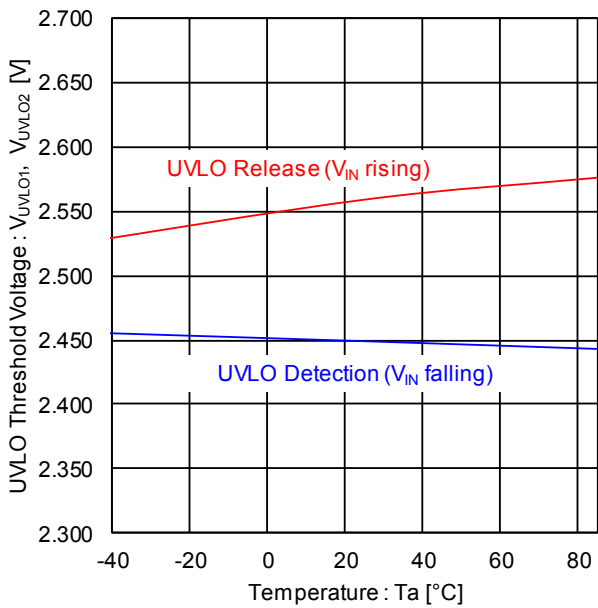


Figure 10. UVLO スレッシュホールド電圧 vs 温度

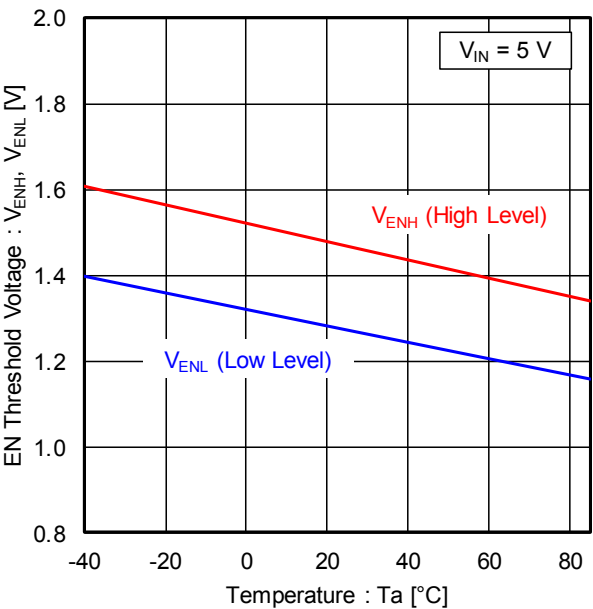


Figure 11. EN スレッシュホールド電圧 vs 温度

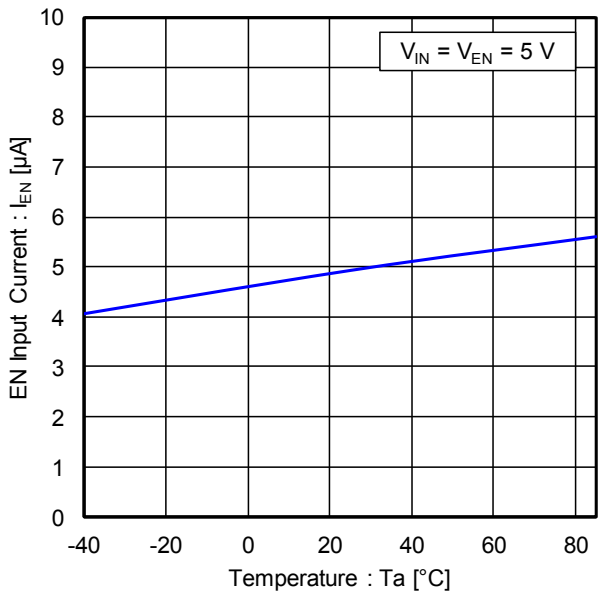


Figure 12. EN 入力電流 vs 温度

特性データ (参考データ) — 続き

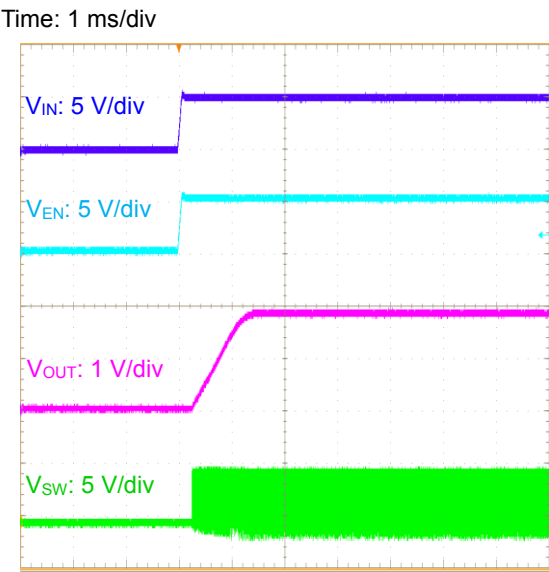


Figure 13.  $R_{LOAD} = 0.9 \Omega$  負荷 起動波形  
( $V_{EN} = V_{IN}$ ,  $V_{IN} = 5 \text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8 \text{ V}$ )

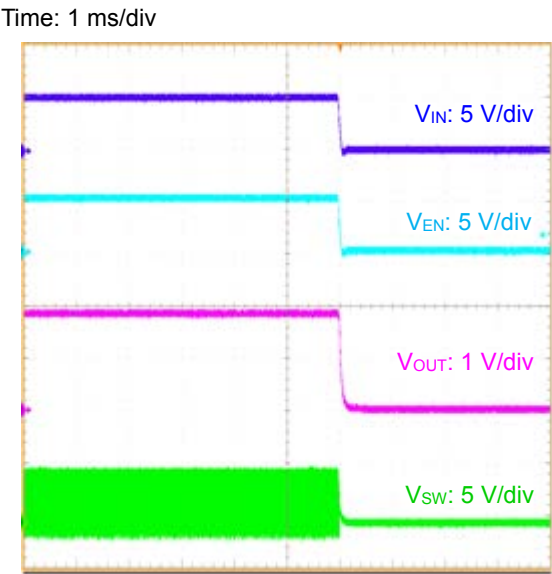


Figure 14.  $R_{LOAD} = 0.9 \Omega$  負荷 シャットダウン波形  
( $V_{EN} = V_{IN}$ ,  $V_{IN} = 5 \text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8 \text{ V}$ )

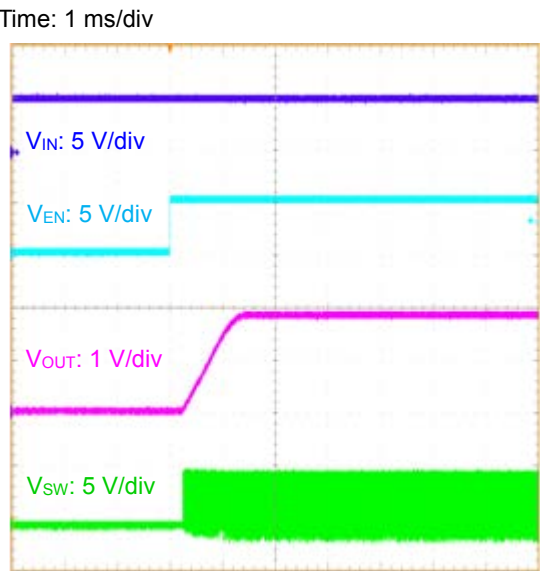


Figure 15.  $R_{LOAD} = 0.9 \Omega$  負荷 起動波形  
( $V_{EN} = 0 \text{ V to } 5 \text{ V}$ ,  $V_{IN} = 5 \text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8 \text{ V}$ )

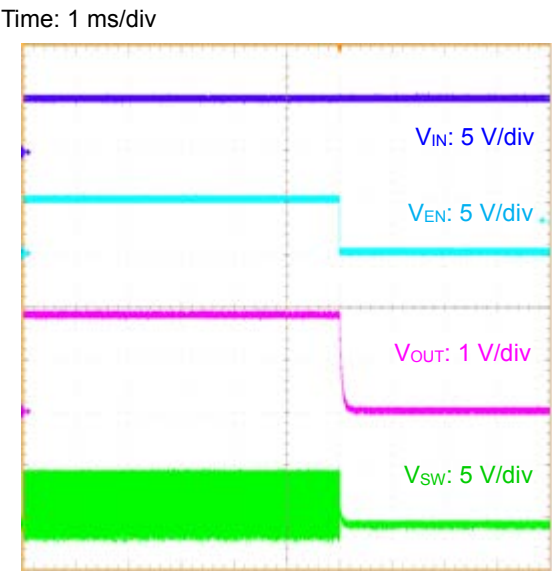


Figure 16.  $R_{LOAD} = 0.9 \Omega$  負荷 シャットダウン波形  
( $V_{EN} = 5 \text{ V to } 0 \text{ V}$ ,  $V_{IN} = 5 \text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8 \text{ V}$ )

特性データ (参考データ) — 続き

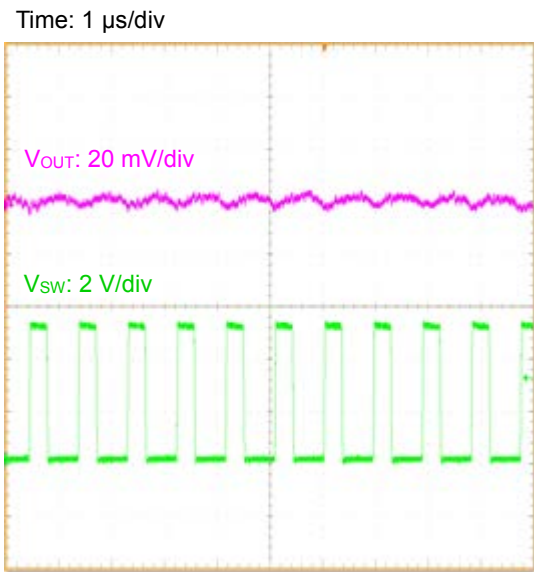


Figure 17. 出力電圧リップル  
( $V_{IN}$  = 5 V,  $V_{OUT}$  = 1.8 V,  $I_{OUT}$  = 0 A)

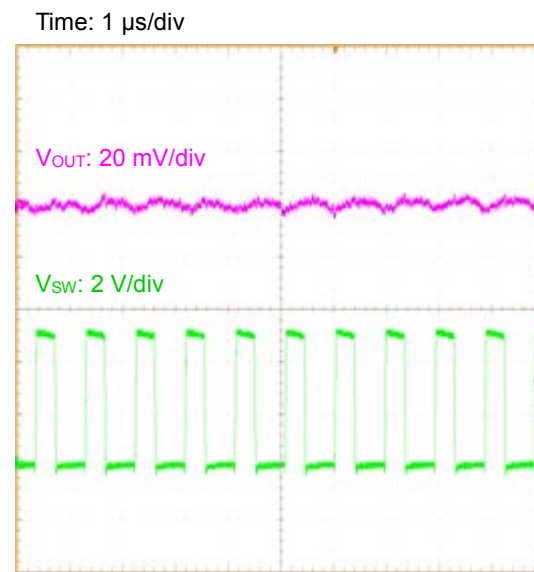


Figure 18. 出力電圧リップル  
( $V_{IN}$  = 5 V,  $V_{OUT}$  = 1.8 V,  $I_{OUT}$  = 2 A)

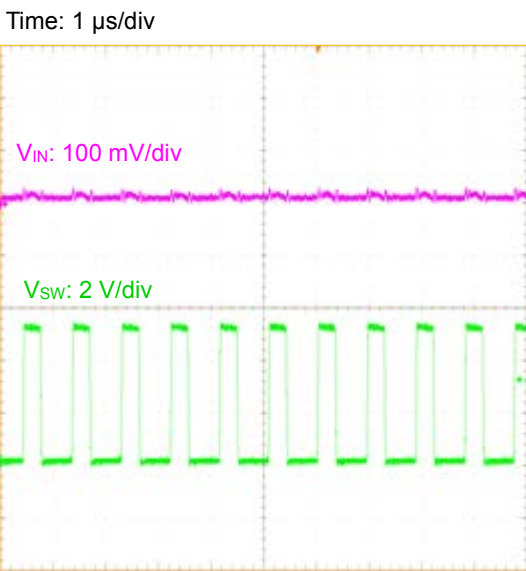


Figure 19. 入力電圧リップル  
( $V_{IN}$  = 5 V,  $V_{OUT}$  = 1.8 V,  $I_{OUT}$  = 0 A)

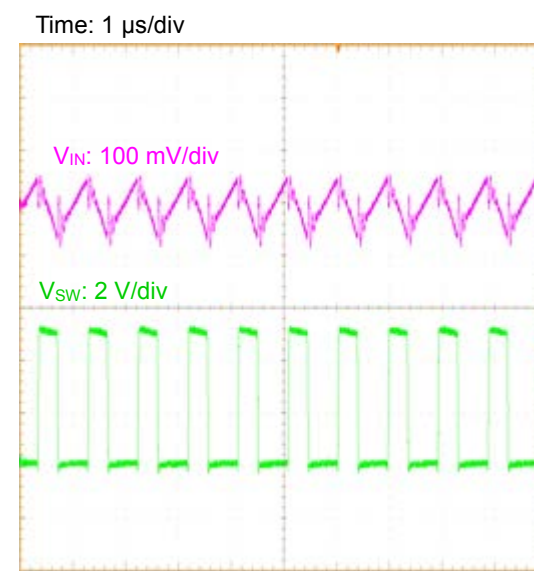


Figure 20. 入力電圧リップル  
( $V_{IN}$  = 5 V,  $V_{OUT}$  = 1.8 V,  $I_{OUT}$  = 2 A)

## 機能説明

## 1. 基本動作

## (1) イネーブル制御

EN 端子電圧  $V_{EN}$  によって、デバイスの起動とシャットダウンを制御できます。 $V_{EN}$  が 2.0 V (Min) 以上になると、内部回路が動作し、デバイスが起動します。 $V_{EN}$  を 0.8 V (Max) 以下にすると、デバイスがシャットダウンします。シャットダウン時は、出力段の High-side FET と Low-side FET が OFF します。 $V_{EN}$  による起動は、入力電圧  $V_{IN}$  の投入と同時に ( $V_{IN} = V_{EN}$ ) または  $V_{IN}$  投入後にしてください。

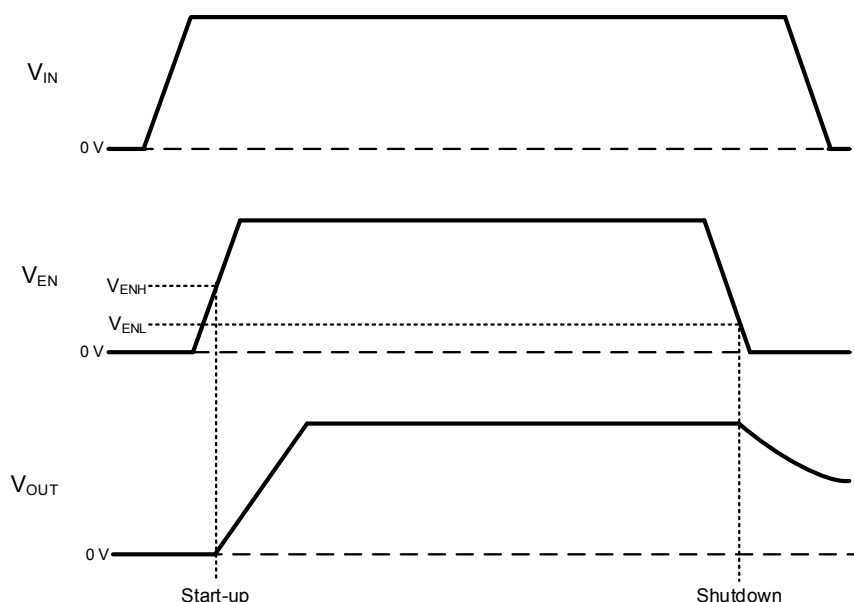


Figure 21. イネーブル制御による起動・シャットダウン タイミングチャート

## (2) ソフトスタート

EN 端子電圧  $V_{EN}$  を High にすると、ソフトスタート機能が動作し出力電圧が緩やかに立ち上がります。また、ソフトスタート機能により、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を防ぐことができます。ソフトスタート時間  $t_{ss}$  は 1.0 ms (Typ) になります。

## (3) パワーグッド機能

出力電圧が設定電圧の  $\pm 7\%$  (Typ) 以内の電圧に達すると PGD 端子に内部接続されているオープンドレイン Nch MOSFET が OFF し、PGD 端子が Hi-Z (ハイインピーダンス) 状態になります。また、出力電圧が設定電圧の  $\pm 10\%$  (Typ) の範囲を外れると、オープンドレイン Nch MOSFET が ON します。10 k $\Omega$  ~ 100 k $\Omega$  の抵抗で電源にプルアップすることを推奨します。

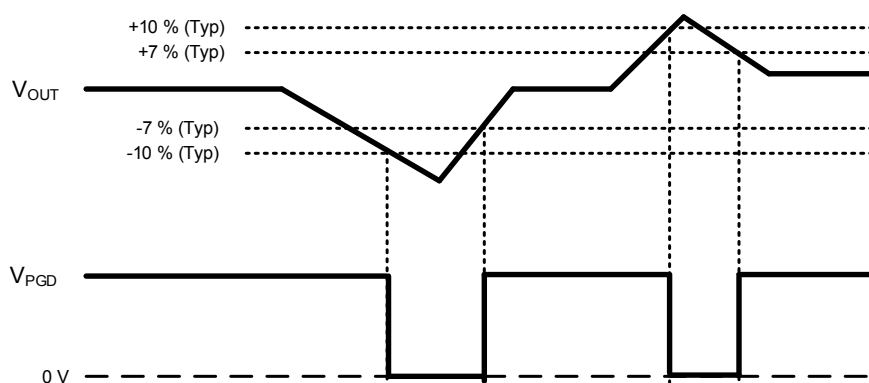


Figure 22. パワーグッド タイミングチャート

## 機能説明 — 続き

## 2. 保護機能

保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なものであり、連続的な保護動作のご使用はしないでください。

## (1) 負荷短絡保護機能 (SCP)

短絡保護回路は、FB 端子電圧  $V_{FB}$  を内部基準電圧と比較し、 $V_{FB}$  が 0.4 V (Typ) 以下の状態が 1 ms (Typ) 継続すると 16 ms (Typ) 間動作を停止し、その後再起動します。ただし、ソフトスタート起動中は SCP 動作条件が成立していても SCP は動作しません。OCP 及び SCP 動作時に最高接合部温度 ( $T_{jmax} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) を超えないようご注意ください。

Table 1. SCP の動作条件

$V_{EN}$	$V_{FB}$	起動	SCP
$\geq 2.0\text{ V (Min)}$	$\leq 0.4\text{ V (Typ)}$	ソフトスタート起動中	無効
	$> 0.4\text{ V (Typ)}$		無効
	$\leq 0.4\text{ V (Typ)}$	起動完了	有効
	$> 0.4\text{ V (Typ)}$		無効
$\leq 0.8\text{ V (Max)}$	-	シャットダウン	無効

## (2) 過電流保護機能 (OCP)

過電流保護機能は High-side FET に流れる電流をスイッチング周波数の 1 サイクルごとに制限することで実現しています。過電流制限値は 6.0 A (Typ) です。

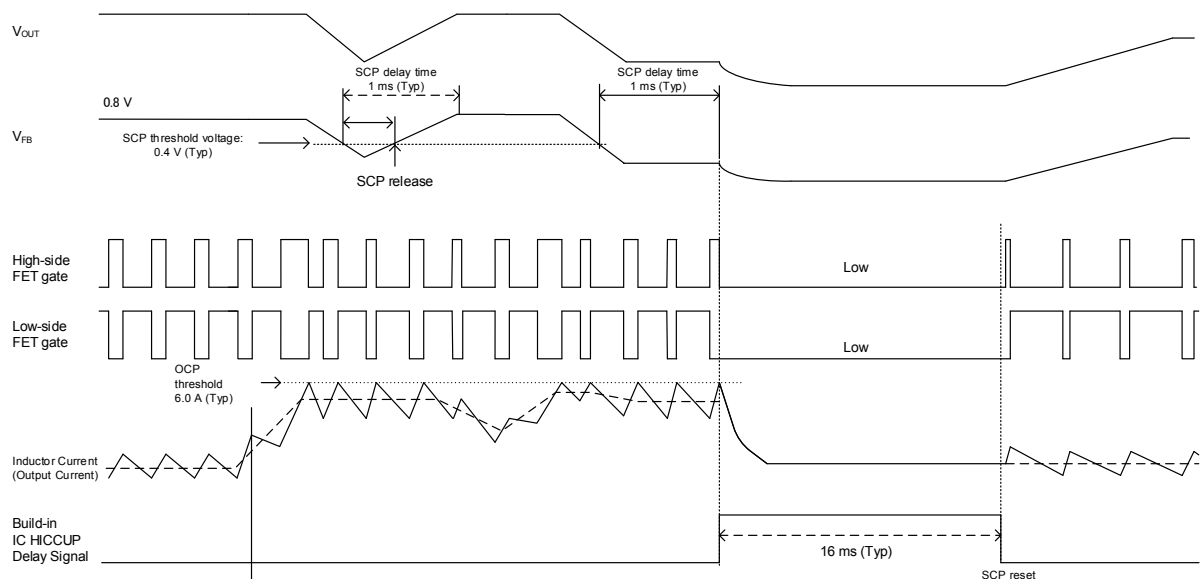


Figure 23. OCP・SCP タイミングチャート

## 2. 保護機能 — 続き

## (3) 低入力電圧誤動作防止機能 (UVLO)

入力電圧  $V_{IN}$  が 2.45 V (Typ) 以下になると、デバイスがシャットダウンします。 $V_{IN}$  が 2.55 V (Typ) 以上になると、デバイスが起動します。ヒステリシスは 100 mV (Typ) です。

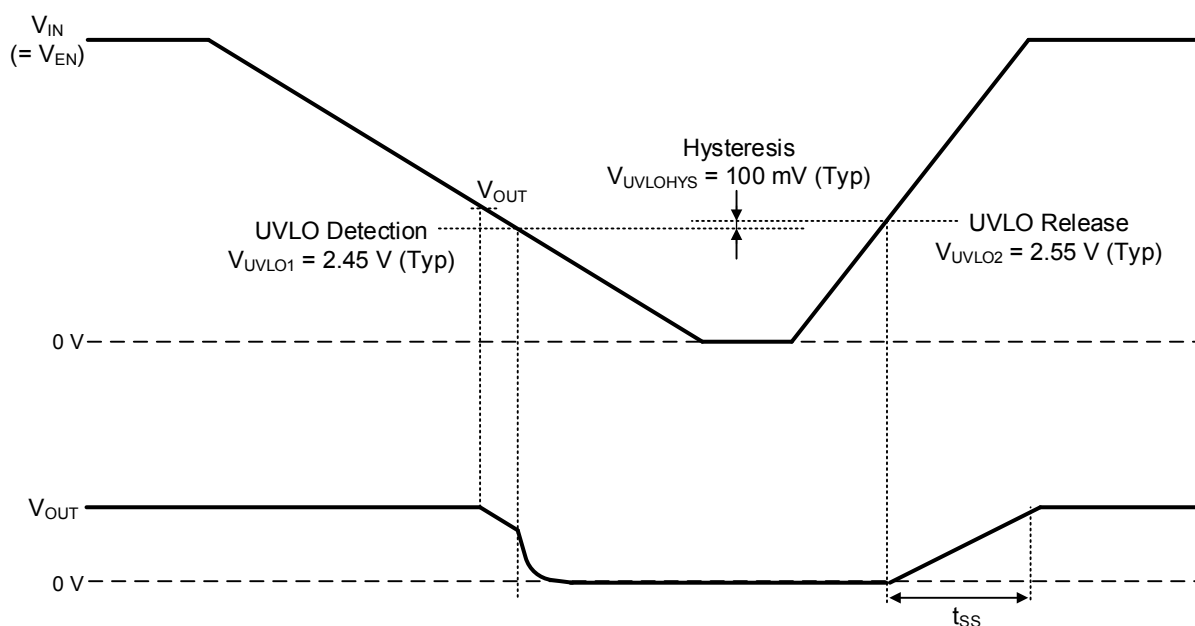


Figure 24. UVLO タイミングチャート

## (4) 温度保護機能 (TSD)

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路です。通常は最高接合部温度 ( $T_{jmax} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) 内で使用しますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続し、チップ温度  $T_j$  が  $175\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Typ) まで上昇すると、温度保護回路 (TSD) が動作し出力段の MOSFET を OFF します。その後、チップ温度  $T_j$  が低下し、TSD スレッシュホールドを下回ると自動で復帰します。TSD スレッシュホールドは、 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Typ) のヒステリシスを持っています。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、セットの温度保護機能として使用しないでください。

## (5) 過電圧保護機能 (OVP)

FB 端子電圧  $V_{FB}$  が FB 端子スレッシュホールド電圧  $V_{FBTH}$  の 110 % (Typ) 以上になると、出力段の MOSFET を OFF し、出力電圧の上昇を抑えます。 $V_{FB}$  が  $V_{FBTH}$  の 107 % (Typ) 以下になると、通常動作状態に戻ります。

## 応用回路例

1.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ 

Table 2. アプリケーション仕様

項 目	記 号	仕様値
入力電圧	$V_{IN}$	5 V (Typ)
出力電圧	$V_{OUT}$	1.8 V (Typ)
出力最大電流	$I_{OUTMAX}$	2 A
周囲温度	$T_a$	25 °C

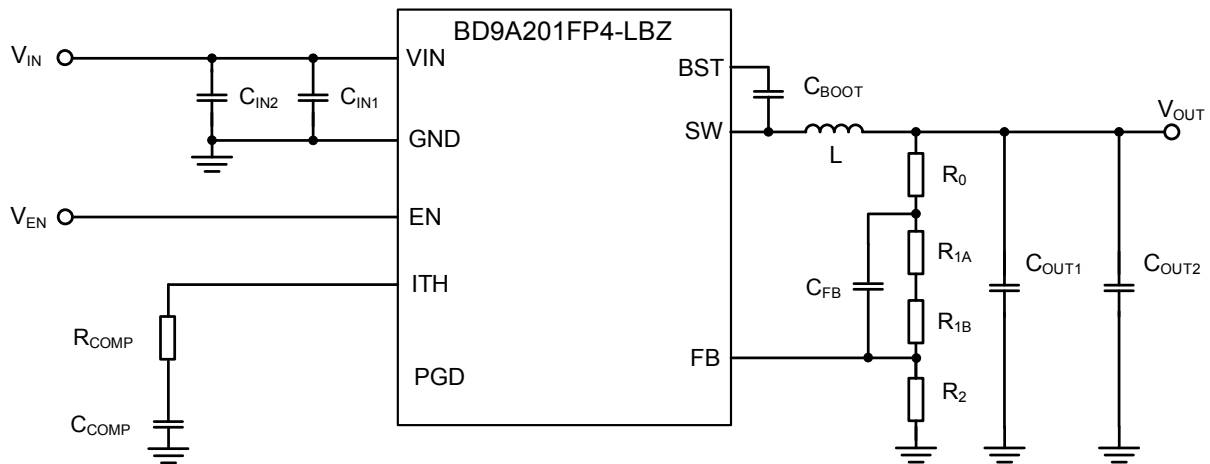


Figure 25. アプリケーション回路図

Table 3. 推奨部品定数

Part No.	Value	Part Name	Size Code (mm)	Manufacturer
L	1.5 $\mu\text{H}$	FDSD0420-H-1R5M	4040	Murata
$C_{IN1}$ (Note 1)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{IN2}$ (Note 2)	22 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A226ME51	2012	Murata
$C_{BOOT}$ (Note 3)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{OUT1}$ (Note 4)	47 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A476ME15	2012	Murata
$C_{OUT2}$	-	-	-	-
$C_{FB}$	-	-	-	-
$C_{COMP}$	2.7 nF (50 V, C0G, $\pm 5\%$ )	GRM1555C1H272JE01	1005	Murata
$R_{COMP}$	9.1 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF9101	1005	ROHM
$R_{1A}$	Short	-	-	-
$R_{1B}$	30 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF3002	1005	ROHM
$R_2$	24 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF2402	1005	ROHM
$R_0$ (Note 5)	Short	-	-	-

(Note 1) 高周波ノイズの影響を低減するために、 $C_{IN1}$ に0.1  $\mu\text{F}$ のセラミック・コンデンサをVIN端子とGND端子の極力近くに配置してください。

(Note 2) 入力コンデンサ  $C_{IN2}$ は温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が3  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 3) ブートストラップコンデンサ  $C_{BOOT}$ は、温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が0.022  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 4) 出力コンデンサ  $C_{OUT1}$ ,  $C_{OUT2}$ の温度特性、DCバイアス特性などにより、実容量値が変わり、位相特性が変動する可能性があります。実アプリケーションでの十分な確認をお願いします。

(Note 5)  $R_0$ はフィードバックの周波数特性測定用であり、オプションとなります。 $R_0$ に抵抗を挿入することで、FRAなどを用いて周波数特性（位相マージン）を測定することができます。なお、実アプリケーションではこの抵抗は使用しないため、ショートして使用ください。

1.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$  — 続き

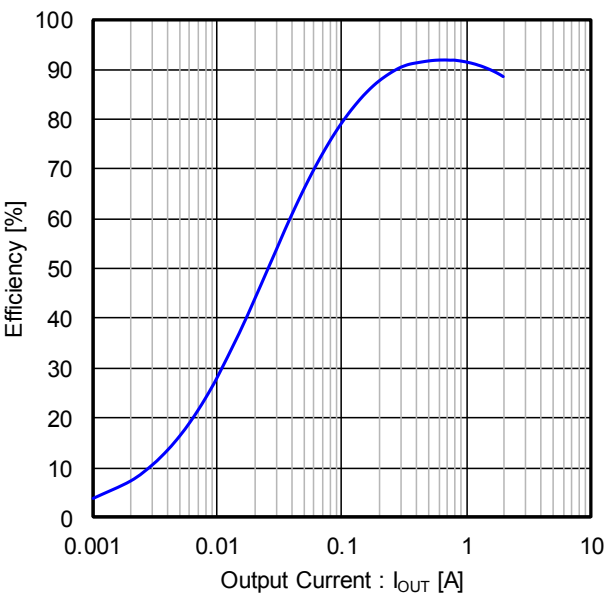


Figure 26. 効率 vs 出力電流

Time: 1  $\mu$ s/div

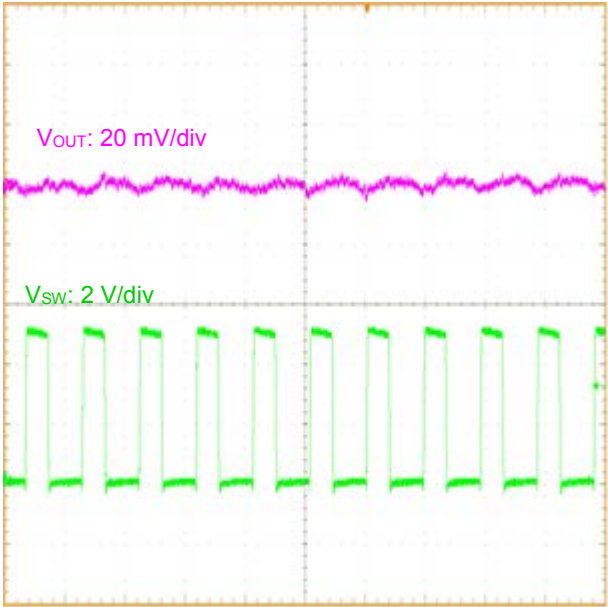


Figure 27. 出力リップル電圧 ( $I_{OUT} = 2\text{ A}$ )

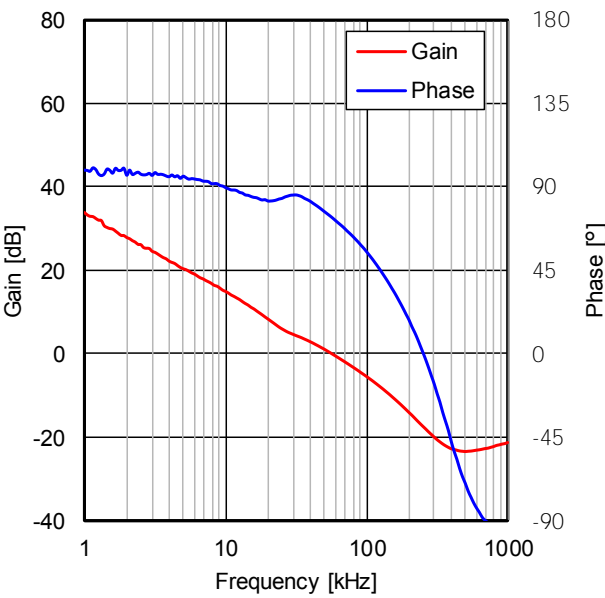


Figure 28. 周波数特性 ( $I_{OUT} = 1\text{ A}$ )

Time: 1 ms/div

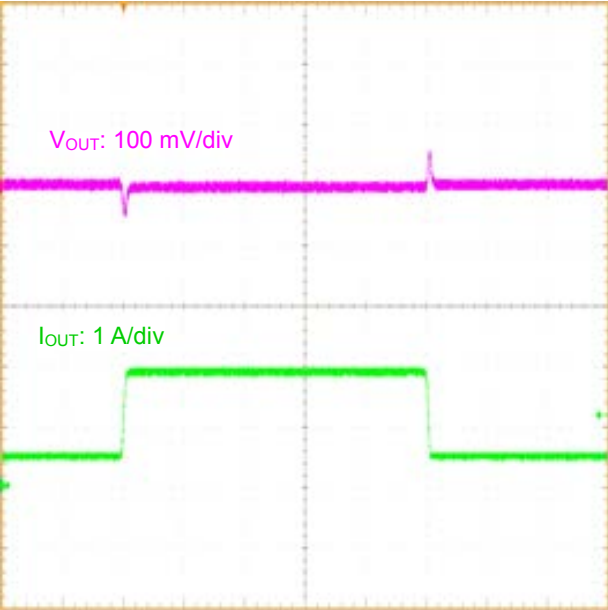


Figure 29. 負荷応答 ( $I_{OUT} = 0.5\text{ A} \sim 2.0\text{ A}$ )



## 応用回路例 — 続き

2.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.5\text{ V}$ 

Table 4. アプリケーション仕様

項 目	記 号	仕様値
入力電圧	$V_{IN}$	5 V (Typ)
出力電圧	$V_{OUT}$	1.5 V (Typ)
出力最大電流	$I_{OUTMAX}$	2 A
周囲温度	$T_a$	25 °C

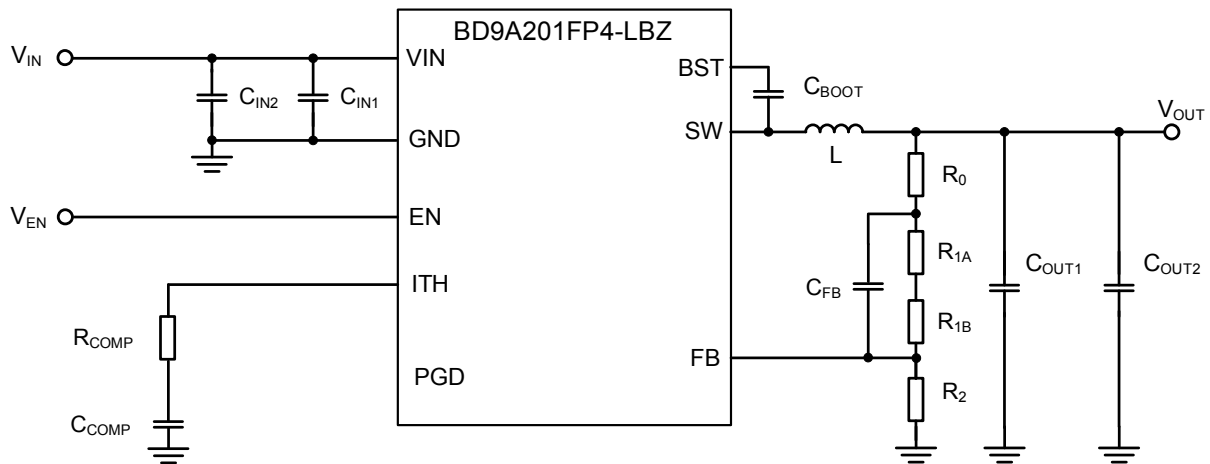


Figure 30. アプリケーション回路図

Table 5. 推奨部品定数

Part No.	Value	Part Name	Size Code (mm)	Manufacturer
L	1.5 $\mu\text{H}$	FDSD0420-H-1R5M	4040	Murata
$C_{IN1}$ (Note 1)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{IN2}$ (Note 2)	22 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A226ME51	2012	Murata
$C_{BOOT}$ (Note 3)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{OUT1}$ (Note 4)	47 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A476ME15	2012	Murata
$C_{OUT2}$	-	-	-	-
$C_{FB}$	-	-	-	-
$C_{COMP}$	2.7 nF (50 V, C0G, $\pm 5\%$ )	GRM1555C1H272JE01	1005	Murata
$R_{COMP}$	9.1 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF9101	1005	ROHM
$R_{1A}$	Short	-	-	-
$R_{1B}$	16 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF1602	1005	ROHM
$R_2$	18 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF1802	1005	ROHM
$R_0$ (Note 5)	Short	-	-	-

(Note 1) 高周波ノイズの影響を低減するために、 $C_{IN1}$ に0.1  $\mu\text{F}$ のセラミック・コンデンサをVIN端子とGND端子の極力近くに配置してください。

(Note 2) 入力コンデンサ  $C_{IN2}$ は温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が3  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 3) ブートストラップコンデンサ  $C_{BOOT}$ は、温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が0.022  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 4) 出力コンデンサ  $C_{OUT1}$ ,  $C_{OUT2}$ の温度特性、DCバイアス特性などにより、実容量値が変わり、位相特性が変動する可能性があります。実アプリケーションでの十分な確認をお願いします。

(Note 5)  $R_0$ はフィードバックの周波数特性測定用であり、オプションとなります。 $R_0$ に抵抗を挿入することで、FRAなどを用いて周波数特性（位相マージン）を測定することができます。なお、実アプリケーションではこの抵抗は使用しないため、ショートして使用ください。

2.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.5\text{ V}$  — 続き

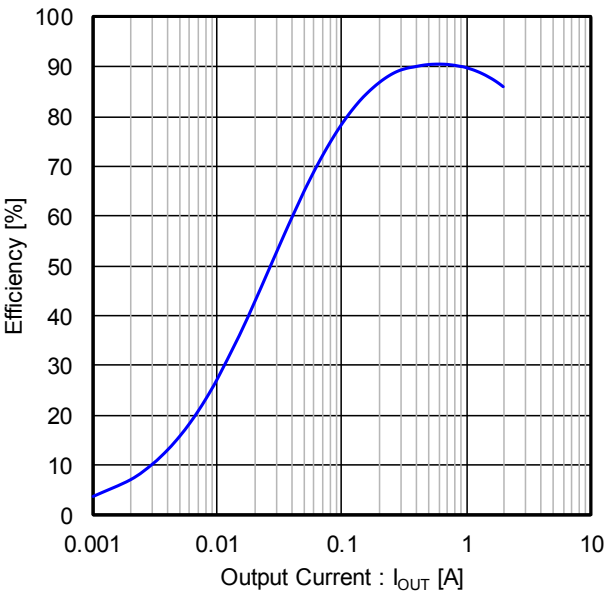


Figure 31. 効率 vs 出力電流

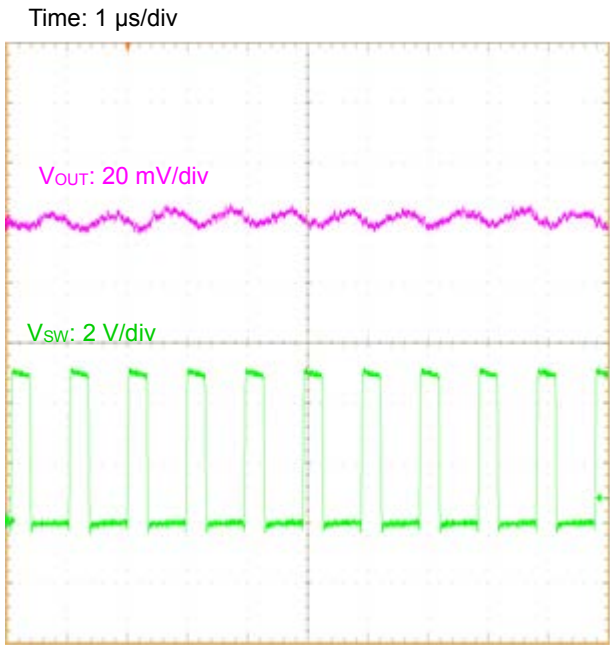


Figure 32. 出力リップル電圧 ( $I_{OUT} = 2\text{ A}$ )

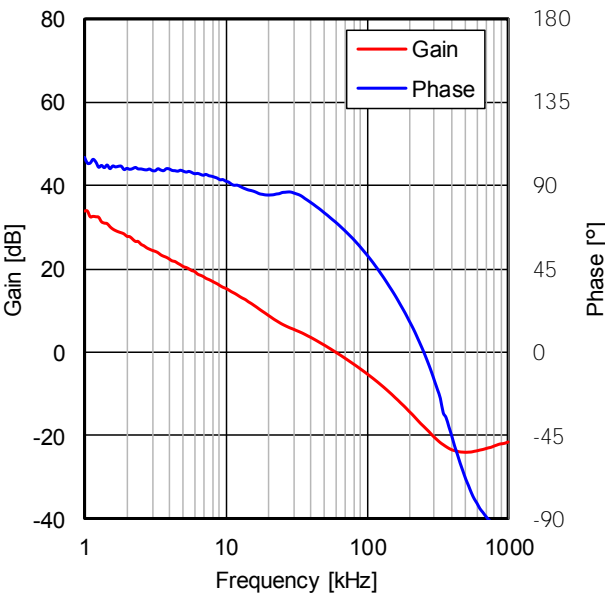


Figure 33. 周波数特性 ( $I_{OUT} = 1\text{ A}$ )

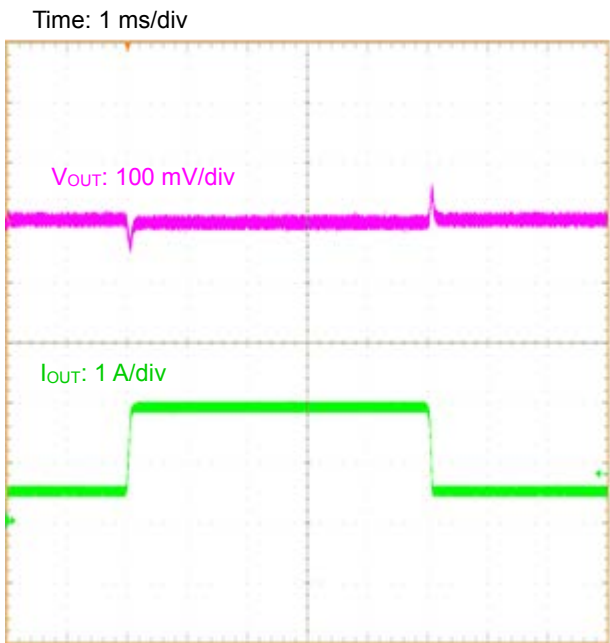


Figure 34. 負荷応答 ( $I_{OUT} = 0.5\text{ A} \sim 2.0\text{ A}$ )

## 応用回路例 — 続き

3.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.2\text{ V}$ 

Table 6. アプリケーション仕様

項 目	記 号	仕様値
入力電圧	$V_{IN}$	5 V (Typ)
出力電圧	$V_{OUT}$	1.2 V (Typ)
出力最大電流	$I_{OUTMAX}$	2 A
周囲温度	$T_a$	25 °C

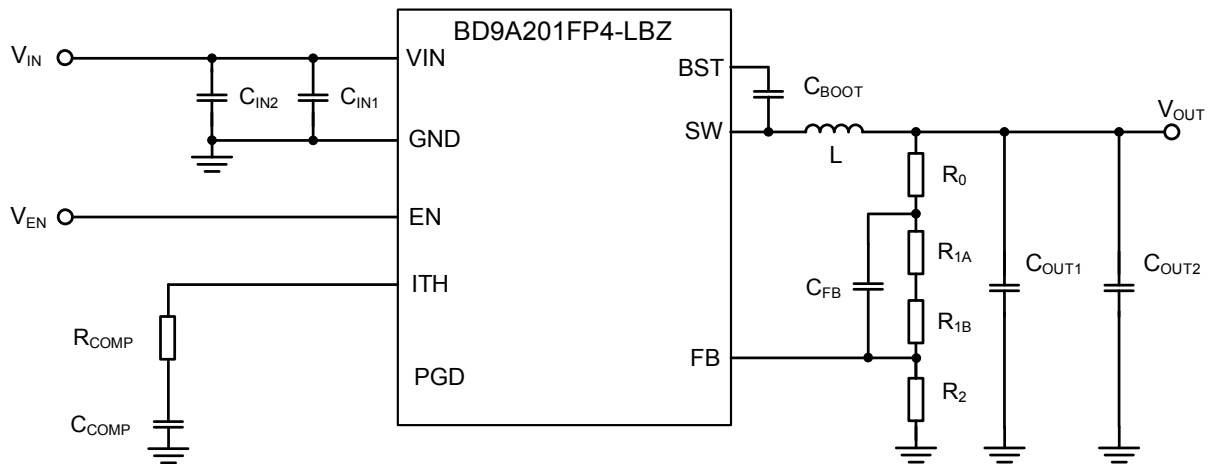


Figure 35. アプリケーション回路図

Table 7. 推奨部品定数

Part No.	Value	Part Name	Size Code (mm)	Manufacturer
L	1.5 $\mu\text{H}$	FDSD0420-H-1R5M	4040	Murata
$C_{IN1}$ (Note 1)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{IN2}$ (Note 2)	22 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A226ME51	2012	Murata
$C_{BOOT}$ (Note 3)	0.1 $\mu\text{F}$ (50 V, X5R, $\pm 15\%$ )	GRM155R61H104KE14	1005	Murata
$C_{OUT1}$ (Note 4)	47 $\mu\text{F}$ (10 V, X5R, $\pm 20\%$ )	GRM21BR61A476ME15	2012	Murata
$C_{OUT2}$	-	-	-	-
$C_{FB}$	-	-	-	-
$C_{COMP}$	2.7 nF (50 V, C0G, $\pm 5\%$ )	GRM1555C1H272JE01	1005	Murata
$R_{COMP}$	9.1 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF9101	1005	ROHM
$R_{1A}$	Short	-	-	-
$R_{1B}$	10 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF1002	1005	ROHM
$R_2$	20 k $\Omega$ (1 %, 1/16 W)	MCR01MZPF2002	1005	ROHM
$R_0$ (Note 5)	Short	-	-	-

(Note 1) 高周波ノイズの影響を低減するために、 $C_{IN1}$ に0.1  $\mu\text{F}$ のセラミック・コンデンサをVIN端子とGND端子の極力近くに配置してください。

(Note 2) 入力コンデンサ  $C_{IN2}$ は温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が3  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 3) ブートストラップコンデンサ  $C_{BOOT}$ は、温度特性、DCバイアス特性などを考慮して、実容量が0.022  $\mu\text{F}$ を下回らないように設定してください。

(Note 4) 出力コンデンサ  $C_{OUT1}$ ,  $C_{OUT2}$ の温度特性、DCバイアス特性などにより、実容量値が変わり、位相特性が変動する可能性があります。実アプリケーションでの十分な確認をお願いします。

(Note 5)  $R_0$ はフィードバックの周波数特性測定用であり、オプションとなります。 $R_0$ に抵抗を挿入することで、FRAなどを用いて周波数特性（位相マージン）を測定することができます。なお、実アプリケーションではこの抵抗は使用しないため、ショートして使用ください。

3.  $V_{IN} = 5\text{ V}$ ,  $V_{OUT} = 1.2\text{ V}$  — 続き

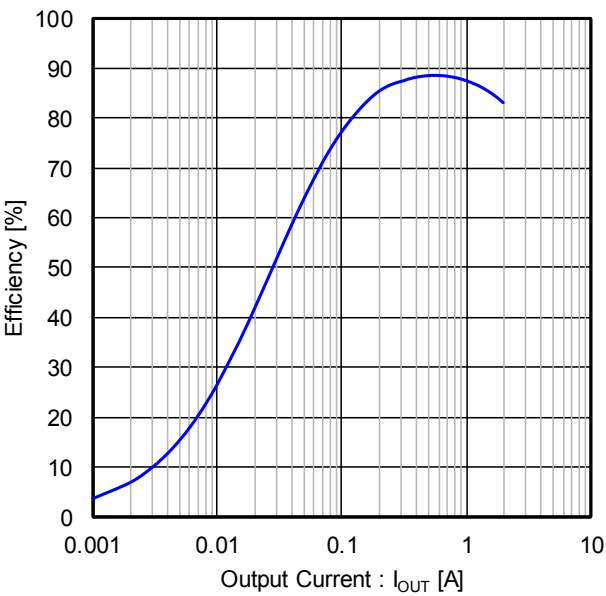


Figure 36. 効率 vs 出力電流

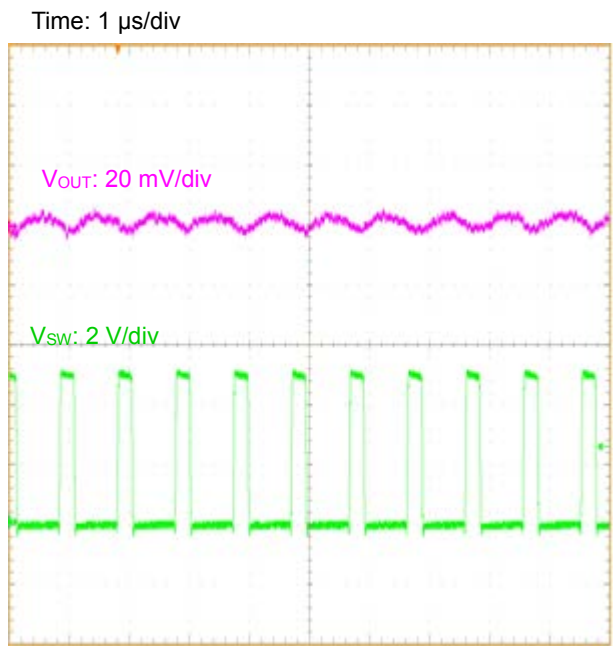


Figure 37. 出力リップル電圧 ( $I_{OUT} = 2\text{ A}$ )

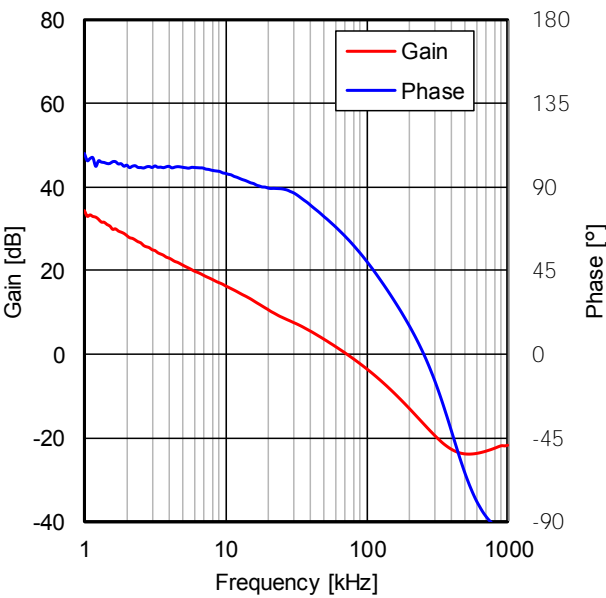


Figure 38. 周波数特性 ( $I_{OUT} = 1\text{ A}$ )

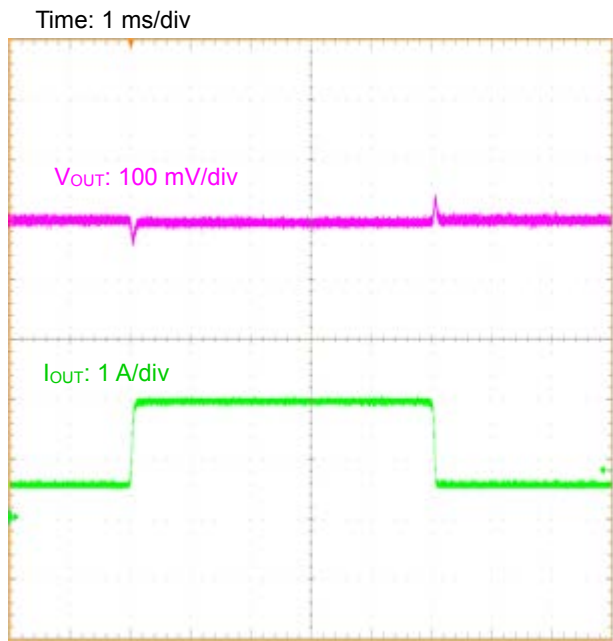


Figure 39. 負荷応答 ( $I_{OUT} = 0.5\text{ A} \sim 2.0\text{ A}$ )

## アプリケーション部品選定方法

[応用回路例](#)に示す推奨定数以外の設定をご使用の場合、弊社までお問い合わせください。

## 1. 入力コンデンサ

入力コンデンサにはセラミック・コンデンサをご使用ください。入力コンデンサは入力リップルノイズの低減に効果があり、VIN 端子の極力近くに配置することでその効果を発揮します。ばらつき、温度特性、DC バイアス特性、経時変化などを含めて実効容量値が 3  $\mu\text{F}$  を下回らないように設定してください。基板パターンやコンデンサの位置によっては、IC が誤動作する可能性がありますので、設計の際は [PCB レイアウト設計について](#)をご参照ください。また、高周波ノイズを低減するために 0.1  $\mu\text{F}$  のコンデンサを VIN 端子と GND 端子の極力近くに配置してください。

## 2. 出力 LC フィルタ

DC/DC コンバータでは、負荷に連続的な電流を供給するために、出力電圧平滑化用の LC フィルタが必要です。

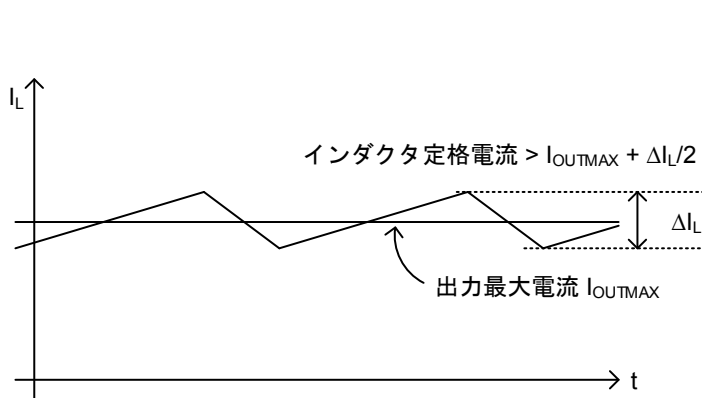


Figure 40. インダクタに流れる電流波形

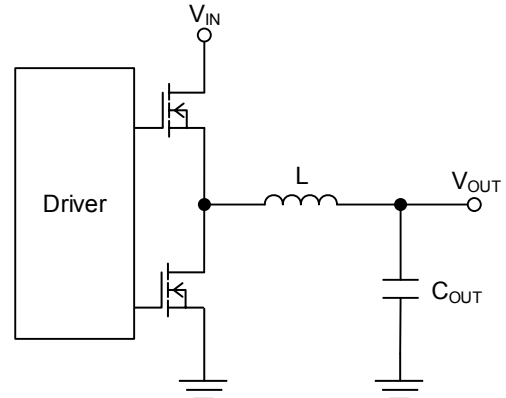


Figure 41. 出力 LC フィルタ回路

$V_{IN} = 5\text{ V}$ 、 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ 、 $L = 1.5\text{ }\mu\text{H}$ 、スイッチング周波数  $f_{OSC} = 1000\text{ kHz}$  で計算するとインダクタ電流  $\Delta I_L$  は次式になります。

$$\Delta I_L = V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT}) \times \frac{1}{V_{IN} \times f_{OSC} \times L} = 0.768\text{ [A]}$$

使用するインダクタの定格電流は、出力最大負荷電流  $I_{OUTMAX}$  にインダクタリップル電流  $\Delta I_L$  の 1/2 を足し合わせた電流よりも大きいものを使用してください。

出力コンデンサ  $C_{OUT}$  にはセラミック・コンデンサを使用してください。

$C_{OUT}$  は出力リップル電圧特性に影響を与えます。必要とされるリップル電圧特性を満たせるように  $C_{OUT}$  を選定してください。

出力リップル電圧は次式で見積もることができます。

$$\Delta V_{RPL} = \Delta I_L \times \left( R_{ESR} + \frac{1}{8 \times C_{OUT} \times f_{OSC}} \right) \text{ [V]}$$

$R_{ESR}$  : 出力コンデンサの等価直列抵抗

ここで  $C_{OUT} = 44\text{ }\mu\text{F}$ 、 $R_{ESR} = 3\text{ m}\Omega$  とすると、出力リップル電圧  $\Delta V_{RPL}$  は

$$\Delta V_{RPL} = 0.768\text{ A} \times \left( 3\text{ m}\Omega + \frac{1}{8 \times 44\text{ }\mu\text{F} \times 1000\text{ kHz}} \right) = 4.5\text{ [mV]}$$

と計算されます。

## 2. 出力 LC フィルタ — 続き

また、出力コンデンサへの充電電流  $I_{CAP}$  は次式で表されます。

$$I_{CAP} = \frac{1}{t_{SS}} \times (C_{OUT} + C_{LOAD}) \times V_{OUT} \text{ [A]}$$

上式より、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$ 、 $V_{OUT} = 3.3 \text{ V}$ 、 $L = 1.5 \text{ } \mu\text{H}$ 、スイッチング周波数  $f_{OSC} = 800 \text{ kHz}$  (Min)、出力コンデンサ  $C_{OUT} = 44 \text{ } \mu\text{F}$ 、ソフトスタート時間  $t_{SS} = 0.5 \text{ ms}$  (Min)、ソフトスタート中の出力負荷電流  $I_{OSS} = 2 \text{ A}$  時の  $V_{OUT}$  に接続可能な最大出力負荷容量  $C_{OUTMAX}$  を計算すると次式になります。

$$C_{OUTMAX} < \frac{t_{SS}}{V_{OUT}} \times \left( 3.8 - I_{OSS} - \frac{\Delta I_L}{2} \right) - C_{OUT} = 157.9 \text{ } [\mu\text{F}]$$

$V_{OUT}$  に  $C_{OUTMAX}$  より大きい容量が接続された場合、起動時の突入電流により過電流保護が動作し出力が起動しない可能性がありますので、実アプリケーションでの十分な確認をお願いします。

## 3. 出力電圧設定

FB 端子に接続するフィードバック抵抗比によって出力電圧値を設定できます。フィードバック抵抗  $R_1$  と  $R_2$  の推奨値は [応用回路例](#) を参照ください。

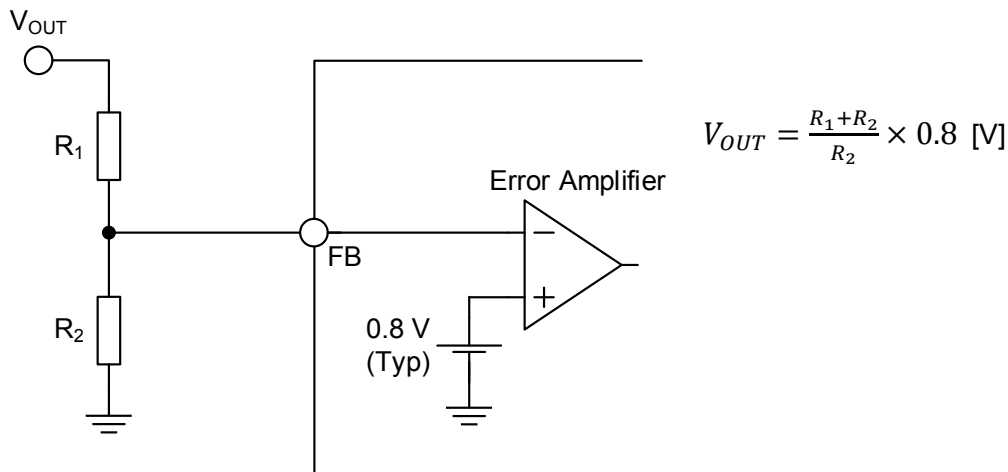


Figure 42. フィードバック抵抗回路

## アプリケーション部品選定方法 — 続き

## 4. 位相補償部品

電流モード制御の降圧 DC/DC コンバータは、誤差増幅器と負荷によって形成される 2 つのポールと位相補償にて付加する 1 つのゼロ点を持つ 2-pole 1-zero システムです。位相補償抵抗  $R_1$  は、DC/DC コンバータのループゲインが 0 dB となる、クロスオーバー周波数  $f_{CRS}$  を決定します。このクロスオーバー周波数  $f_{CRS}$  を高く設定した場合、良好な過渡負荷応答特性が得られますが、安定性において不利になります。一方、クロスオーバー周波数  $f_{CRS}$  を低く設定した場合は、非常に安定した特性になりますが、過渡負荷応答特性において劣ります。

(1) 位相補償抵抗  $R_{COMP}$  の選定

位相補償抵抗  $R_{COMP}$  は、次式にて求めることができます。

$$R_{COMP} = \frac{2 \times \pi \times V_{OUT} \times f_{CRS} \times C_{OUT}}{V_{FB} \times G_{MP} \times G_{MA}} \quad [\Omega]$$

$V_{OUT}$  : 出力電圧

$f_{CRS}$  : クロスオーバー周波数

$C_{OUT}$  : 出力コンデンサ

$V_{FB}$  : フィードバック基準電圧 0.8 V (Typ)

$G_{MP}$  : カレントセンスゲイン 13 A/V (Typ)

$G_{MA}$  : ERR アンプトランスコンダクタンス 260  $\mu$ A/V (Typ)

(2) 位相補償容量  $C_{COMP}$  の選定

DC/DC コンバータを安定動作させるために、負荷によって形成されるポールによる位相遅れをキャンセルするゼロ点 (位相進み) を位相補償容量  $C_{COMP}$  にて決定します。

クロスオーバー周波数の 1/9 以下の位置にゼロ点を挿入することで、多くの場合良好な特性が得られます。

位相補償容量  $C_{COMP}$  は、次式にて求めることができます。

$$C_{COMP} = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{COMP} \times f_Z} \quad [F]$$

$f_Z$  : 挿入されるゼロ点

## (3) ループ安定性について

DC/DC コンバータの安定性と応答性を実機にて確認してください。ワースト条件において、45° 以上の位相マージンを確保することを推奨します。実際には、PCB のレイアウトや配線の引き回し、使用する部品の種類、使用条件(温度など)により特性は変化します。実機での周波数特性の確認には、ゲインフェーズアナライザや周波数特性分析器 FRA を使用します。測定方法については各測定器メーカーにお問い合わせください。

## 5. ブートストラップコンデンサ

ブートストラップコンデンサの値は 0.1  $\mu$ F を推奨します。SW 端子と BST 端子の間に接続してください。ブートストラップコンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性などを考慮して実容量が 0.022  $\mu$ F を下回らないように設定してください。

## PCB レイアウト設計について

DC/DC コンバータの設計において PCB レイアウトの設計は非常に重要です。適切なレイアウトにより、電源に関する様々な問題を回避することができます。Figure 43-a から Figure 43-c は降圧 DC/DC コンバータの電流経路を示した図です。Figure 43-a の Loop1 は上側の switch が ON、下側の switch が OFF 時にコンバータに流れる電流を表しており、Figure 43-b の Loop2 は上側の switch が OFF、下側の switch が ON 時にコンバータに流れる電流を表しています。Figure 43-c の太線は Loop1 と Loop2 の差分を表しています。上下 switch がオフからオンへ、オンからオフへ変化するたびに太線部分の電流は激しく変化します。この系は変化が急峻なため高周波を含んだ波形が現れます。そのため入力コンデンサと IC で構成される太線部の面積をできるだけ小さくすることで、ノイズを減らすことができます。詳細につきましてはスイッチングレギュレータシリーズのアプリケーションノート「降圧コンバータの PCB レイアウト手法」をご参照ください。

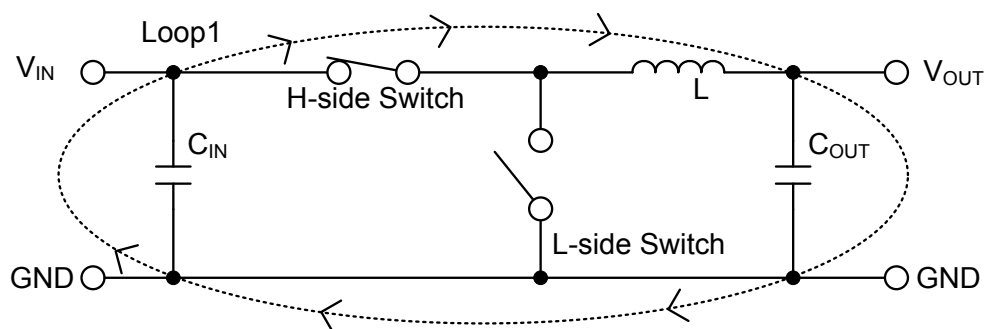


Figure 43-a. H-side Switch: ON, L-side Switch: OFF 時の電流経路

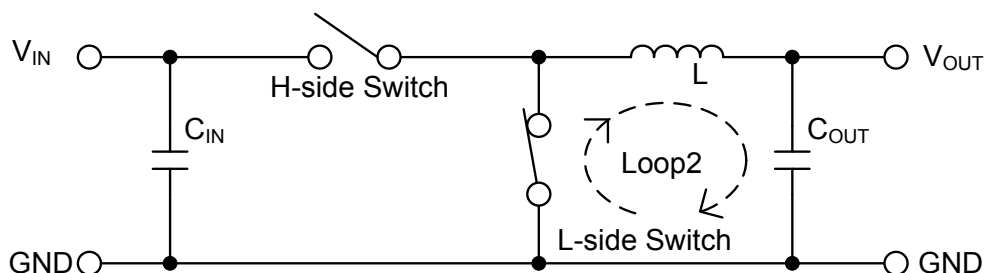


Figure 43-b. H-side Switch: OFF, L-side Switch: ON 時の電流経路

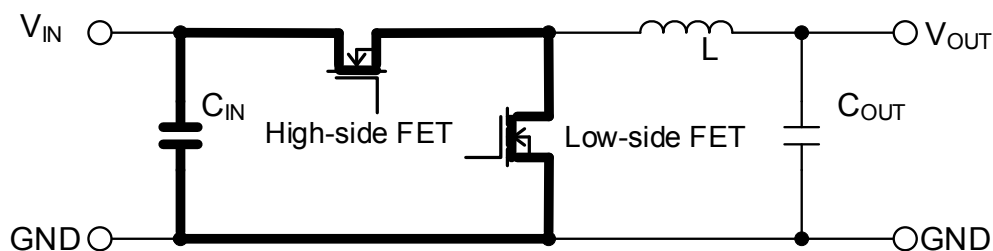


Figure 43-c. 電流の差分、レイアウト上での重要箇所

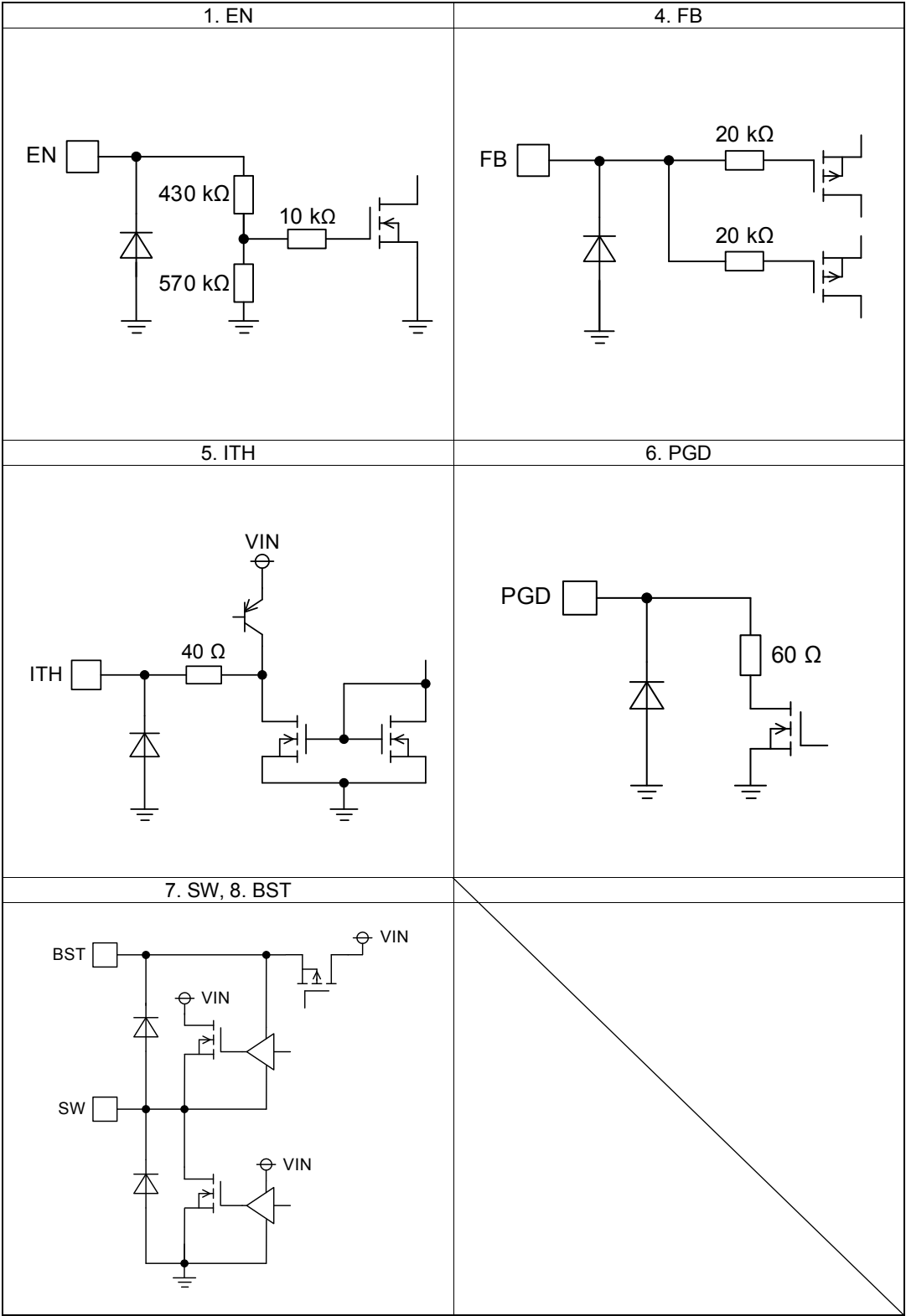


**PCB レイアウト設計について — 続き**

PCB レイアウトを設計する際には、以下に挙げる点を特に注意して設計してください。

- ・入力コンデンサ  $C_{IN1}$ 、 $C_{IN2}$  は IC の VIN 端子と GND 端子に可能な限り近く IC と同じ面に配置してください。
- ・SW などのスイッチングノードは、他ノードへの AC 結合によるノイズの影響が懸念されるため、インダクタ L に可能な限り太く短くトレースしてください。
- ・FB 端子につながるフィードバックラインは、SW のノードとは可能な限り離してください。
- ・出力コンデンサ  $C_{OUT}$  は、入力からの高調波ノイズの影響を避けるため、入力コンデンサ  $C_{IN1}$ 、 $C_{IN2}$  から離して配置してください。
- ・基準系グラウンドとパワー系グラウンドを分け、各々を VIA により接続してください。基準系グラウンドは高周波スイッチングノイズが少ない出力コンデンサ  $C_{OUT}$  付近のパワー系グラウンドと接続してください。
- ・ $R_0$  はフィードバックの周波数特性の測定用であり、オプションとなります。  
 $R_0$  に抵抗を挿入することで、FRA などを用いてフィードバックの周波数特性 (位相マージン) を測定することができます。なお、通常時はショートしてご使用ください。

入出力等価回路図



## 使用上の注意

## 1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

## 2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

## 3. グラウンド電位について

L 負荷駆動端子（例：モータドライバの出力、DC-DC コンバータの出力など）については、L 負荷の逆起電圧の影響でグラウンド以下に振れることが考えられます。L 負荷駆動端子が逆起電圧によって負電位になる場合を除き、グラウンド端子はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子、L 負荷駆動端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。使用条件、環境及び L 負荷個々の特性によっては誤動作などの不具合が発生する可能性があります。IC の動作などに問題のないことを十分ご確認ください。

## 4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

## 5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

## 6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

## 7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

## 8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けした場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

## 9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

## 使用上の注意 — 続き

## 10. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、 $GND > (\text{端子 A})$ の時、トランジスタ(NPN)では  $GND > (\text{端子 B})$ の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ(NPN)では、 $GND > (\text{端子 B})$ の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に  $GND$ (P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が  $GND$  にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

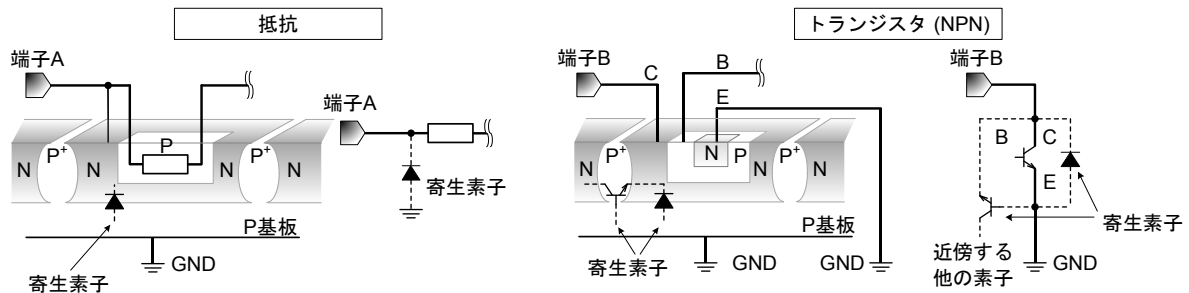


Figure 44. モノリシック IC 構造例

## 11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。

## 12. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度  $T_j$  が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

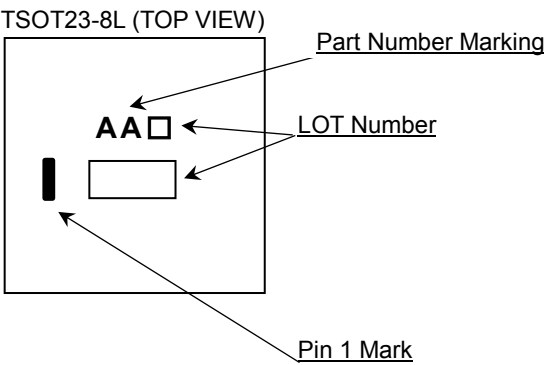
## 13. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

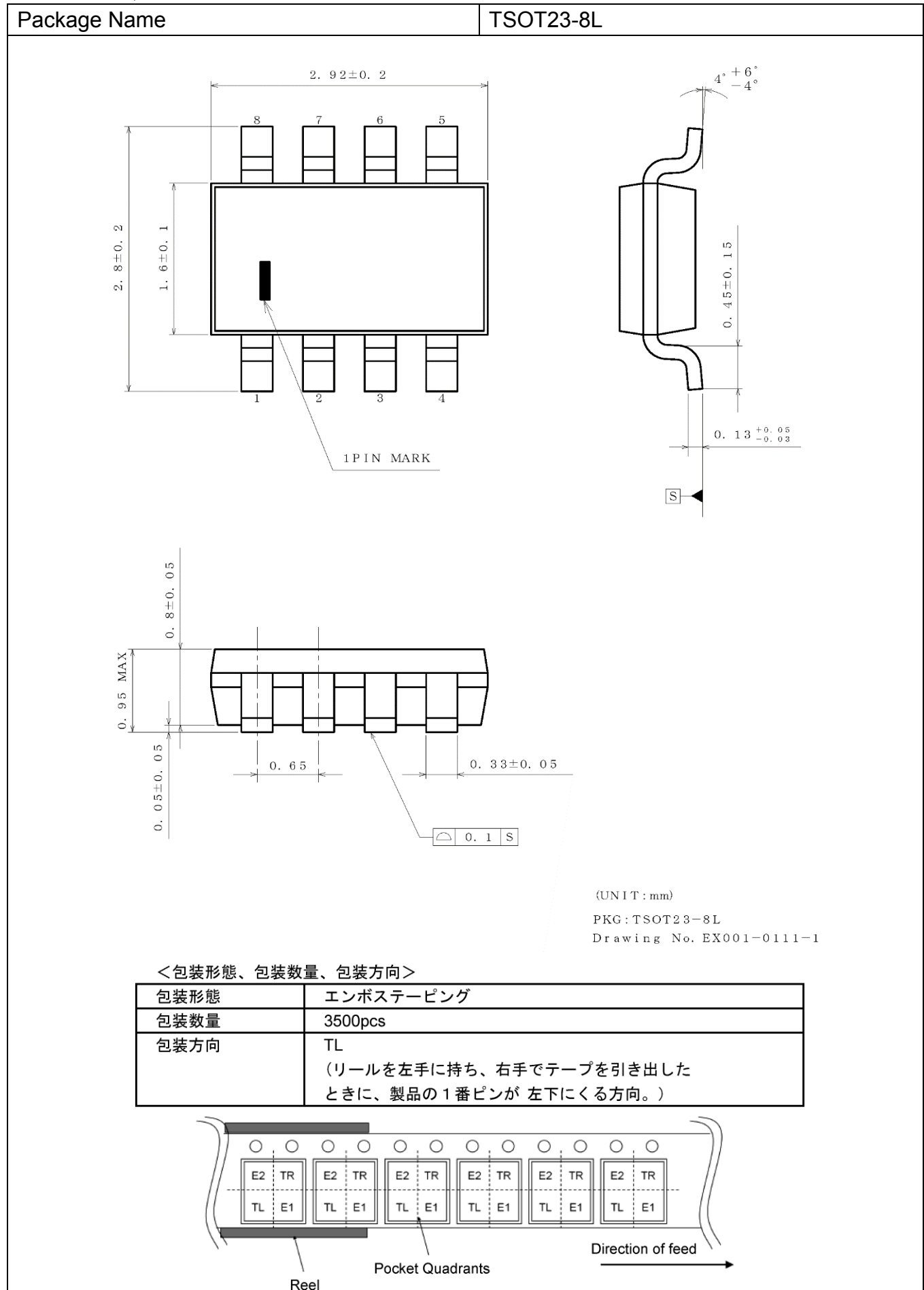
発注形名情報

B D 9 A 2 0 1 F P 4											-	L B Z T L		
パッケージ FP4-Z: TSOT23-8L												製品ランク LB: 産業機器用 包装、フォーミング仕様 TL: リール状エンボステーピング		

標印図



## 外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	版	変更内容
2020.10.26	001	新規作成

# ご注意

## ローム製品取扱い上の注意事項

- 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器<sup>(Note 1)</sup>、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

- 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
  - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
  - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
  - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
  - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
  - ③潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
  - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
  - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
  - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
  - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
  - ⑧結露するような場所でのご使用
- 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
- 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
- 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## 実装及び基板設計上の注意事項

- ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。  
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。



## **応用回路、外付け回路等に関する注意事項**

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## **静電気に対する注意事項**

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

## **保管・運搬上の注意事項**

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
  - ① 潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所での保管
  - ② 推奨温度、湿度以外での保管
  - ③ 直射日光や結露する場所での保管
  - ④ 強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

## **製品ラベルに関する注意事項**

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

## **製品廃棄上の注意事項**

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

## **外国為替及び外国貿易法に関する注意事項**

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

## **知的財産権に関する注意事項**

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

## **その他の注意事項**

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

**一般的な注意事項**

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。